

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 855 662 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

29.07.1998 Patentblatt 1998/31

(51) Int. Cl.⁶: G06F 17/50

(21) Anmeldenummer: 98101077.0

(22) Anmeldetag: 22.01.1998

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 24.01.1997 DE 19702600

(71) Anmelder:

SGS-THOMSON MICROELECTRONICS GMBH
85630 Grasbrunn (DE)

(72) Erfinder: Bonitz, Rainer

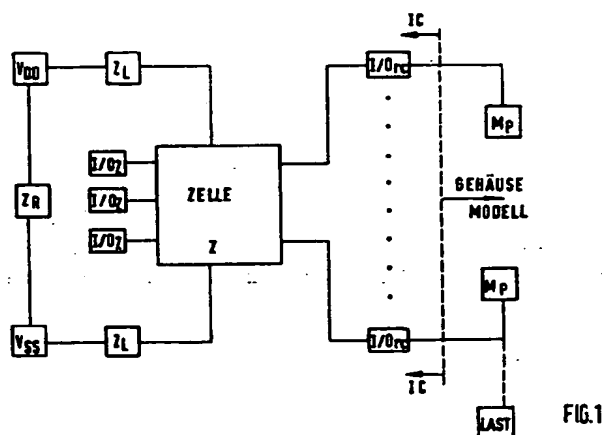
83043 Bad Aibling (DE)

(74) Vertreter: Hirsch, Peter

Klunker Schmitt-Nilson Hirsch
Winzererstrasse 106
80797 München (DE)

(54) Elektrische Analyse integrierter Schaltungen

(57) Verfahren zur Analyse des elektrischen Verhaltens mindestens einer bestimmten Zelle einer monolithisch integrierten Schaltung, mit folgenden Schritten: mitt Is eines bekannten Layout- oder Schaltbild-Analyseprogramms wird von der gesamten integrierten Schaltung anhand von deren Layout bzw. Schaltbild ein Fein-Grob-Computermodell erzeugt, indem erstellt werden: ein aktive und passive Bauelemente und parasitäre Komponenten berücksichtigendes Feinmodell von der interessierenden Zelle und ein nur passive Bauelemente in Form von komplexen Widerständen berücksichtigendes Grobmodell von mindestens dem Rest der integrierten Schaltung; anhand des Fein-Grob-Computermodells wird eine Feinsimulation durchgeführt, indem vorbestimmte Betriebsparameter, wie insbesondere die Betriebstemperatur und die Versorgungsspannung, vorgegeben werden, mindestens ein Eingang des Feinmodells der Zelle mit mindestens einem Stimulationssignal beaufschlagt wird und dabei an Ausgangsanschlüssen der Zelle und/oder der integrierten Schaltung des Fein-Grob-Computermodells entstehende Signalverläufe abgetastet und aufgezeichnet werden; für jeden interessierenden Schaltungsknoten wird mittels einer Spektralanalyseverfahren ein Frequenzspektrum des zugehörigen aufgezeichneten Signalverlaufs erstellt; das Frequenzspektrum wird durch Vergleich mittels einer gespeicherten Frequenzspektrumbewertungsschablone bewertet.



EP 0 855 662 A1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Analyse des elektrischen Verhaltens monolithisch integrierter Schaltungen, welches zur Verbesserung des elektromagnetischen Emissionsverhaltens integrierter Schaltungen eingesetzt werden kann.

Moderne monolithisch integrierte Halbleiterschaltungen mit sehr hohem Integrationsgrad sind meist so komplex, daß man sich sowohl bei ihrem Entwurf als auch bei der Analyse ihres elektrischen Verhaltens und teilweise auch bei ihrer Optiminierung Computerprogrammen bedient. Beispielsweise gibt es Computerprogramme, mittels welchen elektrische Schaltbilder oder Funktionsblockschaltbilder in Layout-Information umsetzbar sind, mittels welcher Layouts für integrierte Halbleiterschaltungen erstellbar sind. Andererseits gibt es Computerprogramme, mittels welchen aus Schaltbildern oder Layouts von integrierten Schaltungen Simulationscomputermodelle erstellbar sind, anhand welcher das Verhalten und/oder die Reaktion der per Computermodell simulierten integrierten Schaltungen oder Teile davon ermittelt oder getestet werden können.

Beispielsweise kann man mit einem Computerprogramm namens AMPS (Automatic Minimization of Power through Sizing) digitale CMOS-Schaltungen hinsichtlich Leistung, Arbeitsgeschwindigkeit und Platzbedarf auf dem Chip optimieren. Dieses Programm ist dazu in der Lage, Transistoren automatisch umzudimensionieren, nämlich größer und/oder kleiner zu machen, um eine Kombination aufzufinden, welche den benutzerdefinierten Zielen hinsichtlich Leistung, Geschwindigkeit und Chipplatzbedarf am nächsten kommt, ohne die Funktionalität des Entwurfs der integrierten Schaltung zu ändern. Dieses Computerprogramm eignet sich einerseits zum Entwurf von Zellen integrierter Schaltungen und kann andererseits nach Beendigung des Entwurfs der integrierten Schaltung zur Überprüfung verwendet werden, ob die angestrebten Ziele erreicht worden sind oder ob weitere Verbesserungen erforderlich sind. Hinweise auf dieses Computerprogramm findet man im HandbuchEPIC 3.3.1 Release Notes, Seite 2-3.

Ein Problem mit zunehmender Bedeutung besteht bei integrierten Halbleiterschaltungen darin, daß durch elektromagnetische Emission hochfrequenter Störstrahlung über Versorgungs- und Funktions-Anschlußpins eines Halbleiterbausteins bei bestimmten Anwendungen andere integrierte Halbleiterschaltungen in ihrer Funktion gestört werden können oder daß der betrachtete Halbleiterbaustein einer Einstrahlempfindlichkeit hinsichtlich solcher hochfrequenter Störstrahlung unterliegt. Es besteht daher das Bestreben, die Güte einer integrierten Schaltung hinsichtlich Abstrahlungsverhalten und/oder Einstrahlempfindlichkeit bezüglich hochfrequenter elektromagnetischer Emission bereits während der Schaltungsentwicklung zu überprüfen und zu optimieren.

In der Veröffentlichung "Analog System Engineering" von Michael Gutzmann, Seiten 8 und 9, ist unter dem Abschnitt "Simultaneous switching noise of CMOS Systems" eine Methode zur Erstellung eines Simulationsmodells und zur Durchführung einer Simulation beschrieben, bei welcher beispielsweise das Schaltungssimulationsprogramm SPICE verwendet werden kann. Dabei werden zunächst durch Erstellung einer R, L, C, G-Matrix elektrische Parameter entweder einer gesamten integrierten Schaltung oder nur einer Zelle hiervon extrahiert, werden einerseits ein elektrisches Netzwerk des Gehäuses mit den Anschlußbeinen und den Anschlußzuleitungen und ein Modell der E/A-Schaltungen (EINGANGS/AUSGANGS-Schaltungen) erstellt und wird auf deren Grundlage eine Schaltungssimulation beispielsweise mit dem Programm SPICE durchgeführt. Die Schaltungssimulation liefert sogenannte Übergangswellenformen in Form einer zeitlichen Aufzeichnung der Stromverläufe an allen interessierenden Schaltungsknoten der integrierten Schaltung bzw. der Zelle.

Verwendet man diese bekannte Methode zur Modellerstellung und Simulation einer gesamten integrierten Schaltung, kann man nur ein relativ grobes Modell erstellen. Denn hochintegrierte Schaltungen heutiger Art sind so komplex, daß man dann, wenn man zu guten Simulationsergebnissen für die gesamte integrierte Schaltung kommen möchte, was ein relativ feines Simulationsmodell und eine ausreichend hohe Auflösung durch Verwendung einer entsprechend hohen Abtastrate der durch Simulation erhaltenen Signalverläufe erfordert, auch bei Verwendung schneller Rechner zu Rechenzeiten käme, die für die Praxis bei weitem zu lang wären. Man müßte mit Rechenzeiten von etwa 2 bis 3 Monaten rechnen.

Um zu praktisch noch akzeptierbaren Rechenzeiten zu kommen, müßte man für die Durchführung der Simulation ein sehr vereinfachtes oder grobes Simulationsmodell und/oder eine sehr schlechte Auflösung durch niedrige Abtastraten verwenden. Beides reduziert zwar die erforderliche Rechenzeit, führt jedoch nur zu recht ungenauen Ergebnissen, die häufig nicht akzeptierbar sind.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, ein Simulationsmodell nicht von der gesamten integrierten Schaltung zu erstellen sondern nur von einer Zelle, das heißt, einem ausschnittweisen Funktionsblock, der integrierten Schaltung zu erstellen. Hierdurch kann man zwar auch mit feineren Simulationsmodellen und mit höherer Auflösung durch Verwendung höherer Abtastraten zu erträglicher Rechenzeit kommen. Das Simulationsergebnis ist aber wiederum zu ungenau, weil die gesamte Umgebung der simulierten Zelle, nämlich der Rest der integrierten Schaltung, Gehäuseparameter, E/A-Strukturen, Zuleitungsstrukturen, Versorgungsspannungsstrukturen usw. gänzlich unberücksichtigt bleiben, obwohl sie auf die Funktion der simulierten Zelle der integrierten Schaltung einen beträchtlichen Einfluß haben können.

Mit der vorliegenden Erfindung sollen solche Probleme überwunden werden. Insbesondere sollen mit praktisch akzeptierbaren Rechenzeiten Simulationen ermöglicht werden, die eine genügend hochwertige Aussage über das Funktionsverhalten, insbesondere im Zusammenhang mit elektromagnetischer Störemission, interessierender Zellen von integrierten Schaltungen ermöglichen.

5 Zu diesem Zweck macht die Erfindung ein Verfahren verfügbar, wie es in Anspruch 1 angegeben ist und das den abhängigen Ansprüchen entsprechend weitergebildet werden kann.

Die Kernidee der Erfindung liegt darin, für die Simulation ein Mischmodell zu verwenden, das zusammengesetzt ist aus einem Feinmodellteil hinsichtlich der interessierenden Zelle und einem Grobmodellteil hinsichtlich des Restes der integrierten Schaltung, wobei man dem Grobmodellteil vorzugsweise auch ein Zuleitungsmodell und/oder ein Spannungsversorgungsmodell und/oder ein Eingangs/Ausgangsstrukturmodell und/oder ein Gehäusestrukturmodell und/oder ein Lastmodell hinzufügen kann. Zur Erstellung des Grobmodellteils werden nur passive Bauelemente in Form von komplexen Widerständen berücksichtigt, während für die Erstellung des Feinmodellteils aktive Bauelemente, passive Bauelemente und parasitäre Komponenten berücksichtigt werden.

15 Das resultierende Fein-Grob-Computermodell weist einerseits eine ausreichend geringe Komplexität auf, um damit eine Simulation mit hoher Auflösungsgenauigkeit und trotzdem für praktische Zwecke genügend kurzer Rechenzeit durchführen zu können, und berücksichtigt andererseits anhand des Grobmodellteils genügend die sich auf das elektrische Verhalten der Zelle auswirkende elektrische Umgebung dieser Zelle.

Für die Modellerstellung und für die Simulation können bekannte Computerprogramme verwendet werden, beispielsweise das Programm DRACULA für die Extraction und das seit langem bewährte Programm SPICE für die Simulation.

20 Bei herkömmlichen Simulationsverfahren werden üblicherweise digitale Stimulationssignale verwendet in Form von Stimulationssignalen mit abgeschrägten Impulsflanken. Solche Stimulationssignale sind aber häufig von der Form wirklich auftretender Signale so weit entfernt, daß sie der Erzielung guter Simulationsergebnisse entgegenstehen.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens werden daher vor der Durchführung der eigentlichen Feinsimulation mittels des Fein-Grob-Computermodells realistischere Stimulationssignale verfügbar gemacht, indem zunächst von der gesamten integrierten Schaltung ein nur deren aktive Bauelemente berücksichtigendes Grobsimulationscomputermodell erzeugt und mit dessen Hilfe eine Grobsimulation durchgeführt wird, indem die vorbestimmten Betriebsparameter vorgegeben und Eingangsanschlüsse des Grobsimulationscomputermodells mit Testsignalen vorbestimmter Signalform beaufschlagt und dabei an Ein- und/oder Ausgangsanschlüssen der interessierenden Zelle des Grobsimulationscomputermodells entstehende analoge Antwortsignale als Stimulationssignale aufgezeichnet und gespeichert werden, die dann als Stimulationssignale bei der Feinsimulation verwendet werden. Zur Extraktion des Grobsimulationscomputermodells kann man z.B. das Programm DRACULA verwenden und für die Grobsimulation einen Mixed Mode Simulator, beispielsweise das Programm ELDO oder das Programm EPIC.

35 Das erfindungsgemäße Verfahren läßt sich vorteilhafterweise zur Verbesserung des elektromagnetischen Emissionsverhaltens der interessierenden Zelle der integrierten Schaltung verwenden, wobei mittels einer programmgesteuerten Iterationsroutine und unter Beachtung vorbestimmter Funktionsgrenzen der Zelle eine gezielte Änderung des Feinmodells der Zelle durchgeführt wird, die Feinsimulation und deren Bewertung wiederholt werden und die Iteration mit erneuten Änderungen des Feinmodells, welche in Betracht ziehen, ob die vorausgehende Änderung zu einem besseren oder schlechteren Ergebnis geführt hat, so lange wiederholt wird, bis sich hinsichtlich des elektromagnetischen Emissionsverhaltens der Zelle nur noch Änderungen unterhalb eines vorbestimmten Schwellenwertes ergeben.

40 Bei der Feinsimulation und gegebenenfalls auch bei der Grobsimulation kann man für die Betriebsparameter entweder typische Werte vorgeben oder "worst case" - Werte, also die im schlechtesten Betriebsfall zu erwartenden Werte. Man kann aber auch die Simulationen sowohl mit typischen Werten als auch mit worst case-Werten durchführen.

45 Bei der Aufzeichnung der bei der Simulation entstehenden Signalverläufe sollte eine Abtastfrequenz verwendet werden, die mindestens so hoch ist wie sie vom Abtasttheorem vorgeschrieben ist, also mindestens zwei mal so hoch wie die höchste im Signalverlauf auftretende Frequenz. Bevorzugt wird jedoch eine wesentlich höhere Auflösung, beispielsweise mit einer Abtastfrequenz, die fünf mal so hoch ist wie die vom Abtasttheorem geforderte Abtastfrequenz. Sind beispielsweise Signalverläufe mit einem Frequenzbereich von 0 bis 1 GHz abzutasten, wird eine Abtastfrequenz mit einem zeitlichen Abstand benachbarter Abtastimpulse von beispielsweise 0,2 ns bevorzugt.

50 Bei periodischen Signalverläufen wird vorzugsweise eine Fourier-Transformation durchgeführt, um das Frequenzspektrum des jeweiligen Signalverlaufs zu erstellen. Bei einmaligen Vorgängen kann die Spektralanalyse auch durch andere Spektralanalysemethoden erfolgen, beispielsweise durch eine Z-Transformation (numerische Methoden). Bei Signalverläufen, die einmalige Vorgänge darstellen, kann man aber auch eine periodische Wiederholung der Simulation des Simulationsmodells durchführen, um zu periodischen Signalverläufen zu kommen, die dann wieder der Fourier-Transformation unterzogen werden können.

55 Bei üblichen Extraktionsverfahren zur Erstellung eines Computermodells mittels der Layout-Extraktion werden zwischen zwei Schaltungsknoten des Simulationsmodells nur beispielsweise ein Widerstand und eine Knotenkapazität

ermittelt. Dabei wird die Knotenkapazität einem der beiden Schaltungsknoten zugeordnet, der Widerstand dagegen dem anderen Schaltungsknoten. Stellt die elektrische Strecke zwischen den beiden Schaltungsknoten eine bidirektionale Verbindung dar, führt diese einseitige Zuordnung von Widerstand und Knotenkapazität zu dem einen bzw. dem anderen Schaltungsknoten zu Verfälschungen der Simulationsergebnisse. Aus diesem Grund erfolgt bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens während der Layout-Extraktion als zusätzlicher Schritt eine Ersatznetzwerkbildung (z.B. mit dem Programm DIVA), bei welcher beispielsweise Widerstände und Kapazitäten entsprechend bekannten Leitungsersatzschaltbildern in einer Anzahl von seriellen Widerständen und Querkapazitäten verteilt sind. Dies kommt der physikalischen Wirklichkeit wesentlich näher und führt daher zu wesentlich besseren Simulationsergebnissen.

Bei der Simulation von Ausgangsstufen einer integrierten Schaltung wird deren Simulationsmodell vorzugsweise nicht mit Leerlauf am Ausgang simuliert sondern unter Berücksichtigung der typisch zu erwartenden externen Last.

Die Erfindung wird nun anhand von Ausführungsformen näher erläutert. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 ein Blockschaltbild eines Fein-Grob-Computermodells, wie es bei einem erfindungsgemäßen Simulationsverfahren verwendbar ist;

Fig. 2 ein elektrisches Schaltbild eines herkömmlichen CMOS-Inverters;

Fig. 3 ein Beispiel eines Chip-Layouts des in Fig. 2 gezeigten Inverters;

Fig. 4 ein aus dem Chip-Layout gemäß Fig. 3 extrahiertes Simulationsmodell des Inverters;

Fig. 5 Beispiele von Hüllkurven als Frequenzspektrumbewertungsschablonen;

Fig. 6-13 durch erfindungsgemäße Simulation erhaltene Signalverläufe vor bzw. nach iterativer Optimierung hinsichtlich des elektromagnetischen Emissionsverhaltens, wobei diese Figuren speziell zeigen:

Fig. 6 einen Signalverlauf am Ausgangsanschlußstift eines Ausgangstreibers einer integrierten Schaltung ohne Optimierung;

Fig. 7 einen Signalverlauf an einer internen Versorgungsspannungsleitung der integrierten Schaltung ohne Optimierung;

Fig. 8 einen Signalverlauf am Ausgangsanschlußstift nach iterativer Optimierung;

Fig. 9 einen Signalverlauf an einer internen Masseleitung der integrierten Schaltung nach iterativer Optimierung;

Fig. 10 ein Frequenzspektrum eines Signalverlaufs an dem Ausgangsanschlußstift ohne Optimierung;

Fig. 11 ein Frequenzspektrum eines Signalverlaufs an der internen Spannungsversorgungsleitung ohne Optimierung;

Fig. 12 ein Frequenzspektrum eines Signalverlaufs an dem Ausgangsanschlußstift nach einer iterativen Optimierung; und

Fig. 13 das Frequenzspektrum eines Signalverlaufs an der internen Spannungsversorgungsleitung nach iterativer Optimierung.

Fig. 1 zeigt ein Beispiel eines Fein-Grob-Computer- oder -Simulationsmodells zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Simulationsverfahrens. Dargestellt ist das Fein-Grob-Simulationsmodell einer integrierten Schaltung, das ein Feinmodell einer hinsichtlich ihres elektrischen Verhaltens interessierenden Zelle Z mit internen Eingängen/Ausgängen I/O_Z und ein Grobmodell von folgenden Komponenten enthält:

- ein Grobmodell Z_R vom Rest des Chips der integrierten Schaltung IC;
- ein Grobmodell V_{DD} und V_{SS} als Spannungsversorgungsmodell,
- ein Grobmodell Z_L als die Zuleitungen zur Zelle Z berücksichtigendes Zuleitungsmodell,
- I/O_{IC} als Eingangs/Ausgangs-Strukturmodell, welches die externen Eingangs/Ausgangs-Anschlüsse der integrier-

ten Schaltung IC berücksichtigt,

- ein Grobmodell M_P als Gehäusemodell zur Berücksichtigung der elektrischen Parameter des Gehäuses und der Gehäuseleitungen der integrierten Schaltung und
- ein Grobmodell LAST, welches die externe Last der integrierten Schaltung repräsentiert.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird folgendermaßen vorgegangen:

1. Zunächst wird von der gesamten integrierten Schaltung ein Grobsimulationscomputermodell erzeugt, das nur deren aktive Komponenten, wie Dioden und Transistoren, berücksichtigt. Hierzu kann ein herkömmliches Computerprogramm verwendet werden, beispielsweise das bereits erwähnte Programm DRACULA, mittels welchem in Form einer Schaltungslayoutextraktion eine Netzlistenbeschreibung erzeugt wird, welche nur die aktiven Komponenten der integrierten Schaltung berücksichtigt. Anhand dieses Grobsimulationscomputermodells wird dann eine Grobsimulation durchgeführt. Dabei werden bestimmte Betriebsparameter vorgegeben wie insbesondere die Betriebstemperatur und die Versorgungsspannung, sowie Parameter des verwendeten Extraktionsprogramms und des verwendeten Simulationsprogramms. Die Eingangsanschlüsse des Grobsimulationscomputermodells werden dann mit Testsignalen vorbestimmter Signalform beaufschlagt. Diese rufen an interessierenden Ein- und/oder Ausgangsanschlüssen des Grobsimulationscomputermodells analoge Antwortsignale hervor, die als Stimulationssignale für die spätere Feinsimulation aufgezeichnet und gespeichert werden. Diese Stimulationssignale berücksichtigen schon grob das elektrische Verhalten der integrierten Schaltung und sind daher für eine nachfolgende Feinsimulation wesentlich besser geeignet und führen zu wesentlich besseren Simulationsergebnissen als wenn man die Feinsimulation mit der Beaufschlagung mit Testsignalen beginnen würde, ohne die Grobsimulation vorzuschicken.

2. Als nächstes wird dann ein Fein-Grob-Computer- oder Simulationsmodell erstellt. Hierzu beginnt man beispielsweise mit der Erstellung des Feinmodells der interessierenden Zelle Z. Hierbei kann man sich wieder eines herkömmlichen Computerprogramms bedienen, das mit Hilfe einer Schaltungslayoutextraktion eine Netzlistenbeschreibung erzeugt. Diese enthält für den Zweck der Erstellung des Feinmodells jedoch nicht nur die aktiven Komponenten (beispielsweise Transistoren und Dioden) der Zelle Z sondern auch deren passive Komponenten (Widerstände, Kapazitäten, Induktivitäten) und alle parasitären Elemente (dargestellt ebenfalls in Form von Widerständen, Kapazitäten und Induktivitäten), welche durch die Geometrien auf dem Halbleiterchip der integrierten Schaltung bedingt sind. Damit ist der in Fig. 1 als Zelle Z bezeichnete Teil des Fein-Grob-Simulationsmodells erstellt.

3. Zur Vervollständigung des Fein-Grob-Simulationsmodells werden nun noch die Grobmodelle Z_R , Z_L , V_{DD} , V_{SS} , I/O_{IC} , M_P und LAST erstellt. Auch hierfür kann man wieder das herkömmliche Computerprogramm zur Netzlistenbeschreibung mit Hilfe einer Schaltungslayoutextraktion verwenden, wobei allerdings nur passive Schaltungskomponenten in Form von komplexen Widerständen berücksichtigt werden.

Die Auswahl, ob nur aktive Komponenten, nur passive Komponenten oder sämtliche Komponenten einschließlich parasitärer Elemente in eine Netzlistenbeschreibung für ein Simulationsmodell aufgenommen werden sollen, kann man beispielsweise durch Filter bewirken, welche bei der jeweiligen Schaltungslayoutextraktion nur die jeweils gewünschten Komponenten in die Netzliste lassen.

Bei der Gehäuseanalyse zur Erstellung des Gehäuse-Grobmodells wird vorzugsweise von dem Gehäuse der integrierten Schaltung ein Ersatzschaltbild in Form eines RLC-Netzwerkes erstellt, wobei die Werte der einzelnen Ersatzschaltbildkomponenten auf Messungen basieren. Es wird ein Modell für jeden Anschlußpin des Gehäuses erstellt.

4. Nach Erstellung eines der Fig. 1 entsprechenden Fein-Grob-Simulationsmodells wird dann anhand dieses Modells eine Feinsimulation durchgeführt. Dabei werden beispielsweise die gleichen Betriebsparameter wie bei der vorausgehenden Grobsimulation vorgegeben und werden als Stimulationssignale die bei der Grobsimulation aufgezeichneten und gespeicherten Antwortsignale des Grobsimulationscomputermodells verwendet. Hierbei werden möglichst viele Teile des Fein-Grob-Simulationsmodells durch Stimulation aktiviert, um die simulierte Zelle Z in alle möglichen elektrischen Zustände zu versetzen. Dadurch werden sowohl Einschwingvorgänge berücksichtigt als auch Vorgänge und Reaktionen, die erst im eingeschwungenen Zustand auftreten.

5. An den interessierenden Stellen des Fein-Grob-Simulationsmodells werden die durch die Simulationen hervorgerufenen Signalverläufe abgetastet und aufgezeichnet. Vorzugsweise findet die Aufzeichnung solcher Signalverläufe statt, die an die integrierte Schaltung IC verlassenden Schaltungsknoten entstehen, das heißt, an den letzten Schaltungsknoten, bevor es in die externe Umwelt des Chips der integrierten Schaltung geht. Die Aufzeichnung

dieser Signalverläufe erfolgt mit möglichst hoher Abtastrate, die vorzugsweise fünf mal so hoch wie die vom Abtasttheorem geforderte Abtastrate ist, um eine hohe Auflösung und damit gute Simulationsergebnisse zu erhalten.

6. Anschließend wird eine Spektralanalyse der aufgezeichneten und gespeicherten Signalverläufe des Fein-Grob-Simulationsmodells durchgeführt, vorzugsweise mit Hilfe einer Fourier-Transformation, mit deren Hilfe ein Frequenzspektrum der abgetasteten und aufgezeichneten Signalverläufe erstellt wird. Hierbei kann man sich eines "Waveform postprocessor" bedienen, beispielsweise des Programms XELGA. Hierbei sollten die für eine Spektralanalyse wichtigen Parameter, wie Abtastfrequenz und Anzahl der Abtastungen, beachtet werden.

Die Darstellung im Frequenzbereich erfolgt vorzugsweise in doppellogarithmischer Skalierung, wobei der Betrag und die Phase der komplexen Amplitude dargestellt werden.

7. Die Auswertung des Simulationsergebnisses erfolgt durch eine Bewertung der Störampplituden in der Frequenzspektrumdarstellung des jeweiligen Signalverlaufs, wobei die Höhe der Störampplitude ein Maß für die Güte des jeweiligen Schaltungsknotens bezüglich einer möglichen HF-Abstrahlung darstellt. Die Auswertung und Bewertung erfolgt dabei beispielsweise entsprechend bekannter VDE-Richtlinien oder bekannter SAE-Normen der USA.

8. Durch gezieltes Abändern der zu untersuchenden Schaltung und erneutes Durchführen der Schritte 1. bis 7. kann eine Verbesserung des Störemissionsverhaltens der Zelle erreicht werden.

Anhand der Fig. 2 bis 4 wird an dem einfachen Beispiels eines CMOS-Inverters eine Modellextrahierung erläutert. Ein CMOS-Inverter der in Fig. 2 dargestellten Art enthält zwei in Reihe geschaltete MOS-Transistoren M1 und M2 entgegengesetzten Kanaltyps, die zwischen die beiden Versorgungsspannungsanschlüsse V_{DD} und V_{SS} einer Spannungsversorgungsquelle geschaltet sind. Die Gate-Anschlüsse der beiden Transistoren M1 und M2 sind gemeinsam mit einem Eingangsanschluß A verbunden und deren Drainanschlüsse sind gemeinsam mit einem Ausgangsanschluß B verbunden. Ein dem Eingangsanschluß A zugeführter Rechteckimpuls hat am Ausgangsanschluß B einen invertierten Ausgangsimpuls zur Folge, wobei in Fig. 2 ideale Impulse und ideale Übertragungseigenschaften des Inverters angenommen sind.

Fig. 3 zeigt ein mögliches Layout eines Inverters der in Fig. 2 gezeigten Art. Mit dicker Umrahmung sind die MOS-Transistoren M1 und M2 dargestellt. Leiterbahnen für die Spannungsversorgung einerseits und für die Verbindung der Gatezonen und der Drainzonen der beiden Transistoren M1 und M2 mit dem Eingangsanschluß A bzw. dem Ausgangsanschluß B sind schraffiert dargestellt.

Fig. 4 zeigt ein einfaches extrahiertes Modell eines Inverters mit dem in Fig. 3 gezeigten Layout. Dabei sind neben den aktiven Komponenten M1 und M2 nur Widerstände und eine Kapazität in das extrahierte Modell aufgenommen worden. Ein genaueres Modell könnte weitere Kapazitäten und zusätzlich Induktivitäten enthalten, möglicherweise auch parasitäre Komponenten der Transistoren M1 und M2. Eine weitere Verfeinerung könnte darin bestehen, die passiven Elemente entsprechend der Leitungstheorie aufzuteilen (z.B. mit dem Programm DIVA).

In dem extrahierten Modell in Fig. 4 sind im wesentlichen die durch die metallischen Leiterbahnen gebildeten Leitungswiderstände berücksichtigt, nämlich Sourcezuleitungswiderstände R_{S1} und R_{S2} , die Drainzuleitungswiderstände R_{D1} und R_{D2} , die Gatezuleitungswiderstände R_{G1} und R_{G2} sowie die Leitungswiderstände R_A und R_B der Verbindungsleitungen mit den Anschlüssen A und B. Außerdem ist eine zwischen dem gemeinsamen Drainanschluß und der Masseleitung (V_{SS}) vorhandene Kapazität C dargestellt.

Aufgrund der Berücksichtigung derartiger Widerstände und Kapazitäten in dem extrahierten Modell führt bei diesem Modell die Simulation der Einspeisung eines idealen Rechteckimpulses am Eingangsanschluß A nicht zu einem entsprechend idealen invertierten Ausgangsimpuls am Ausgangsanschluß B sondern dort erscheint als Simulationsergebnis ein "realer" invertierter Impuls mit bestimmten Impulsschragen und Einschwingbereichen.

Die Umsetzung einzelner in Schaltbilddarstellung vorliegender Bauelemente oder Bauelementegruppen von integrierten Schaltungen in entsprechende Chip-Layouts können heutzutage Computerprogramme automatisch durchführen. Dies gilt auch für das Erstellen oder Extrahieren eines Computermodells aus einem solchen Layout. Aus den Mustern und Dimensionen solcher Layouts kann das Computerprogramm die parasitären Komponenten, die neben den aktiven Elementen in Form der Transistoren M1 und M2 bestehen, ermitteln und in das extrahierte Modell mit einbringen.

Im praktischen Fall der Analyse oder Optimierung einer interessierenden Zelle einer integrierten Schaltung ist diese Zelle wesentlich komplexer als ein einfacher Inverter der in Fig. 2 gezeigten Art. Die programmgesteuerte Layout-Erstellung und/oder Modellextrahierung geschieht aber prinzipiell gleich.

In Fig. 5 ist ein angenommenes Beispiel für ein Frequenzspektrum eines bei einer Feinsimulation erhaltenen Signalverlaufs dargestellt, zusammen mit Bewertungshüllkurven, welche die Funktion von Bewertungsschablonen haben. Dargestellt sind eine angenommene Hüllkurve einer Güteklasse A sowie eine angenommene Hüllkurve einer Güteklasse B. Je nach dem, welche Güteklasse man anwendet, wäre der Signalverlauf, dessen Frequenzspektrum in

Fig. 5 dargestellt ist, akzeptabel oder nicht.

Die Fig. 6 bis 9 zeigen simulierte Signalverläufe an verschiedenen Stellen eines Simulationsmodells einer integrierten Schaltung vor bzw. nach einer Optimierung hinsichtlich elektromagnetischer Störemissionen mittels einer erfindungsgemäßen Simulationsmethode. Dabei zeigen die Fig. 6 und 8 ein simuliertes Ausgangssignal an einem Ausgangsanschluß eines Ausgangstreibers der simulierten integrierten Schaltung vor bzw. nach der Optimierung, während die Fig. 7 und 9 Signalverläufe an einer internen Spannungsversorgungsleitung (Masseleitung) des Simulationsmodells der integrierten Schaltung vor bzw. nach der Optimierung zeigen.

Ein Vergleich der Fig. 6 und 8 zeigt als hauptsächlichsten Effekt der Optimierung eine deutliche Verringerung der Steilheit sowohl der Anstiegsflanke als auch der Abfallflanke, was eine entsprechende Reduzierung der hohen Frequenzanteile in diesem Impulssignal und damit eine entsprechende Reduzierung der hochfrequenten Störemission bedeutet.

Ein Vergleich der Fig. 7 und 9 zeigt, daß die Amplitude des Störspannungssignals auf der internen Masseleitung von etwa 90 mV vor der Optimierung auf etwa 10 mV nach der Optimierung abgenommen hat, also nahezu um den Faktor 10.

In den Fig. 10 bis 13 sind Frequenzspektren der durch die Simulation erhaltenen Signalverläufe an dem Ausgangsanschluß des Modells der integrierten Schaltung bzw. auf einer internen Spannungsversorgungsleitung dargestellt.

Ein Vergleich der Fig. 10 und 12 zeigt eine Abnahme der oberen Hüllkurve im mittleren Frequenzbereich des Frequenzspektrums für den Ausgangsanschluß infolge der Optimierung um etwa 20 dB. Eine ähnliche Reduzierung der Störemission ergibt sich für das simulierte Signal auf der internen Spannungsversorgungsleitung, wie ein Vergleich der Fig. 11 und 13 zeigt.

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist somit eine automatische Optimierung von integrierten Schaltungen mit parameterorientierten Simulatoren möglich.

In abgeänderter Weise kann das Verfahren auch zur Ermittlung der Störfestigkeit integrierter Schaltungen gegen Störeinstrahlungen angewendet werden. Dabei können auf interne Spannungsversorgungsleitungen, einschließlich Masseleitungen, und/oder auf externe Anschlußpins des Simulationsmodells der integrierten Schaltung, welche für die Funktion der interessierenden Fälle bedeutend oder charakteristisch sein können, Stimulationssignale gegeben werden und kann die Erwartung mit dem Simulationsergebnis verglichen werden. Anhand des Frequenzspektrums aufgezeichneter Signalverläufe kann die Störfestigkeitsgüte der interessierenden Zelle bewertet werden. Hierfür kann man Stimulationssignale verwenden, deren Frequenzen gewobbeln sind und deren Leistungen und/oder Amplituden iterativ verschieden gemacht werden.

Vor einer Übertragung von Schaltungen oder Schaltungsteilen einer integrierten Schaltung in andere Halbleitertechnologien (einschließlich Dimensionsänderung bezüglich des Schaltungslayouts) kann deren Verhalten durch einfaches Austauschen der Simulationsmodelle vorhergesagt werden. Hierfür kann entweder eine neue Extraktion zur Erstellung eines neuen Simulationsmodells durchgeführt werden oder man kann eine Bewertung mit einem an die neuen Halbleitertechnologien angepaßten Simulationsmodell durchführen.

Die Modularisierung in Zellen und die Verwendung eines Fein-Grob-Modells mit Berücksichtigung der elektrischen Umwelt der interessierenden Zelle erlaubt gute Simulationsergebnisse bei Anwendbarkeit des Verfahrens auch bei begrenzter Rechnerleistung.

Neben der Möglichkeit, mit dem erfindungsgemäßen Verfahren eine interessierende Zelle zu verbessern, kann mit dem erfindungsgemäßen Verfahren auch der Einfluß verschiedenster Parameter auf das Störabstrahlverhalten untersucht werden. Solche Parameter sind beispielsweise Gehäuseparameter, Eingangs/Ausgangs-Strukturen, R, L, C-Netzwerke auf dem Chip, Versorgungsnetze, Taktfrequenzen und Taktstrategien, beispielsweise hinsichtlich der Form der Taktimpulse, Technologieparameter u.s.w.

Es folgt nun noch eine Liste von Bezugsquellen für vorausgehend genannte Computerprogramme und für weitere für das erfindungsgemäße Verfahren geeignete Programme:

SOFTWARE	ANWENDUNGSGEBIET	ANBIETER
SPICE	Analoge Schaltungssimulation	Cadence, Haar bei München
DRACULA	Layoutextraktion (Netzliste) Layoutverifikation	Cadence
DIVA	Layoutextraktion (Netzliste) Layoutverifikation	Cadence

(fortgesetzt)

SOFTWARE	ANWENDUNGSGEBIET	ANBIETER
ELDO	Mixed mode simulation	Mentor Graphics, München
EPIC (Amps, Timemill, Powermill,...)	Mixed mode simulation	Epic, Grenoble
	Timing-Verifikation	
	Schaltungsanalyse	
	Schaltungsoptimierung	
XELGA	Wellenformanzeige und	Mentor Graphics
	Wellenform-Postprozessor	
	(z.B. Fourier-Analyse)	
VERILOG	Digitale	Cadence
	Schaltungssimulation	

Alle Programme besitzen sogenannte Online-Manuals und werden weltweit vertrieben und benutzt.

Verfahren der hier beschriebenen Art zur Analyse und Optimierung von integrierten Schaltungen können einerseits eingesetzt werden, um integrierte Schaltungen, die zunächst nur in einer virtuellen Welt in Form von Schaltbildern und/oder Layout-Zeichnungen und in Form von Computermodellen vorliegen, zu bewerten und zu optimieren, bevor sie in eine reale Welt umgesetzt werden, nämlich in Halbleiterchips. Da die Umsetzung in wirkliche Halbleiterchips sehr zeit- und kostenaufwendig ist, werden solche Bewertungs- und Optimierungsvorgänge in der virtuellen Welt stark bevorzugt und zunehmend eingesetzt. Dabei ist erwünscht und angestrebt, eine weitestgehende Automatisierung zu erreichen, derart, daß Analyse- und/oder Optimierungsverfahren gemäß vorliegender Erfindung in einen automatisierten Programmablauf eingebaut werden, der sowohl auf der Anfangsseite als auch auf der Endseite automatisierte Schnittstellen zur physikalischen Welt enthält, derart, daß beispielsweise Meßergebnisse auf der Eingangsseite und Herstellungssteuereinrichtungen, beispielsweise Maskenherstellungs- oder Layouttrimmeinrichtungen, auf der Ausgangsseite, über eine eingangsseitige bzw. ausgangsseitige automatisierte Schnittstelle mit dem erfindungsgemäßen Analyse- und/oder Optimierungsverfahren verknüpft werden. Von der Meßeinrichtung bis zur Maskenherstellungs- oder Layouttrimmeinrichtung kann dann eine durchgängige Programmsteuerung erfolgen, welche keinerlei Eingreifen oder Einflußnahme durch Menschen mehr bedarf.

Nachfolgend werden einige praktische Möglichkeiten derartiger vollautomatisierter Abläufe betrachtet.

Falls bereits eine integrierte Schaltung (nachfolgend in üblicher Weise mit IC abgekürzt) bereits existiert, kann man unter Zuhilfenahme des erfindungsgemäßen Verfahrens eine Analyse und/oder Optimierung des IC vornehmen, was vollständig automatisiert geschehen kann. Beispielsweise erfolgt eine Analyse und/oder Optimierung im Hinblick auf elektromagnetische Störstrahlungen des IC, wie sie sich an einzelnen Anschlußstiften oder Pins des IC auswirken.

Zunächst erfolgt eine pin-selektive Messung der elektromagnetischen Abstrahlung des Prüflings-IC. Für diese wird vorzugsweise ein Meßverfahren gemäß dem Normierungsvorschlag VDE AK 767.13/14.5, veröffentlicht in "Messung der EME von integrierten Schaltungen", erschienen bei ZVEI Fachverband Bauelemente der Elektronik, Königstorgraben 11, 90402 Nürnberg, Version 1.1, Mai 1995, verwendet. Zur pin-selektiven Messung kann ein Roboter verwendet werden, der automatisiert eine Pin-zu-Pin-Umschaltung bewirkt, wodurch der Reihe nach alle oder ausgewählte Pins hinsichtlich ihrer Störabstrahlung gemessen werden. Aufgrund dieser Messungen wird beispielsweise der Pin mit der höchsten Störabstrahlung ermittelt. Anhand einer Datenbank, in welcher gespeichert ist, welche Pins des IC mit welchen Zellen des IC verbunden sind, wird ermittelt, welche Zelle bzw. welche Zellen zu dem aufgrund der gemessenen Störabstrahlung ausgewählten Pin gehört bzw. gehören. Für eine derart ermittelte Zelle des IC wird dann das erfindungsgemäße Verfahren durchgeführt. Zu diesem Zweck kann entweder nach Ermittlung der Zelle anhand eines Layout- oder Schaltbild-Analyseprogramms das Fein-Grob-Computermodell für die ausgewählte Zelle des IC erstellt und das erfindungsgemäße Analyseverfahren durchgeführt werden. Eine andere Möglichkeit ist die, auf eine Datenbank zurückzugreifen, in welcher für die einzelnen Zellen des IC bereits Fein-Grob-Computermodelle der erfindungsgemäßen Art gespeichert sind, und dasjenige Fein-Grob-Computermodell aus dieser Datenbank abzurufen, das zu der aufgrund der pin-selektiven Messung der Störabstrahlung ermittelten Zelle gehört. Dieses Verfahren kann entweder bis zu einem Analyseergebnis des in Anspruch 1 angegebenen Verfahrens oder bis zu einer Optimierung mit dem in Anspruch 3 angegebenen Verfahren durchgeführt werden. Das softwaremäßige Analyse- oder Optimierungsergebnis kann dann dazu verwendet werden, um ein programmgesteuertes IC-Herstellungsverfahren, insbesondere Maskenherstellungsverfahren oder Leiterbahnttrimmverfahren, mit den bei der vorausgehenden Analyse oder Optimierung erhaltenen Parametern zu steuern.

Der ganze Vorgang von der pin-selektiven Messung bis zur Maskenherstellung für ein modifiziertes IC oder für ein Leiterbahntrimmen des existierenden IC während des Herstellungsprozesses kann vollautomatisiert, das heißt, ohne jeglichen Eingriff durch Menschen, ablaufen. Zu diesem Zweck können einzelne Programmteile, wie das die pin-selektive Messung und die Roboterfunktion steuernde Programm, das erfindungsgemäße Analyse- oder Optimierungsprogramm und das die Maskenherstellung oder Leiterbahntrimmung steuernde Programm, über gegenseitige Programmschnittstellen zu einem Gesamtprogramm zusammengefaßt werden. Es ist dann allenfalls noch erforderlich, die einzelnen Programme der bereits existierenden Art mit geeigneten Schnittstellen und/oder Programmfiltern zu versehen, damit die einzelnen Programme in Zusammenfügung vollautomatisiert den gesamten Ablauf von der pinselektiven Messung bis zur Maskenerstellung oder Leiterbahntrimmung abwickeln können.

Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines erfindungsgemäßen Verfahrens für eine bewertete Stromaufnahme eines erst virtuell oder schon tatsächlich integrierten IC. Dabei wird zunächst wieder das Layout- oder Schaltbild der integrierten Schaltung mittels eines Layout- oder Schaltbild-Analyseprogramms zur Erstellung eines Computermodells eingelesen. Danach wird eine Grobsimulation nach Art des in Anspruch 2 angegebenen Verfahrens durchgeführt. Anhand des bezüglich Stromaufnahme bewerteten Grobsimulationsergebnisses wird eine Zelle des IC ausgewählt. Die Strombewertung erfolgt dabei vorzugsweise nach der Art des zeitlichen Stromwertwechsels. Zellen, die eine Stromaufnahme in Form nur oder im wesentlichen nur eines konstanten Gleichstroms haben, somit keine oder praktisch keine Störabstrahlung verursachen, können außer Betracht bleiben, wenn es wieder um die Analyse oder Optimierung von Zellen hinsichtlich ihres Störabstrahlverhaltens geht. Zellen dagegen, die eine Stromaufnahme mit hohen und/oder häufigen Stromstärkewechseln aufweisen, somit besonders zur Störabstrahlung beitragen, werden für eine Analyse oder Optimierung ausgewählt. Für die so ausgewählte Zelle wird dann das erfindungsgemäße Simulationsverfahren mit Fein-Grob-ComputermodeLL durchgeführt, an dessen Ende die hinsichtlich Störabstrahlung analysierten oder optimierten Parameter der Zelle feststehen.

Am Anfang dieses Verfahrens zur bewerteten Stromaufnahme steht entweder die Grobsimulation (insbesondere wenn nur eine virtuelles IC vorliegt) oder eine Messung der Stromaufnahme, wenn bereits ein tatsächlich existierendes IC vorliegt. Mit dem am Ende des Verfahrens vorliegenden Analyse- oder Optimierungsergebnis können durch das Programm wieder physikalische Größen gesteuert werden, beispielsweise bei der Maskenherstellung für das herzustellende tatsächliche IC oder für eine Leiterbahntrimmung eines bereits existierenden IC.

Auch hier kann wieder eine volle Automatisierung vom Einlesen des IC-Schaltbildes bzw. von der Durchführung der Stromaufnahmемessungen bis zur Maskenherstellung bzw. Leiterbahntrimmung durchgeführt werden, indem die einzelnen Programmteile über geeignete Schnittstellen zu einem funktionsmäßig durchgängigen Gesamtprogramm zusammengefügt werden.

Während sich die vorausgehenden Beispiele hauptsächlich mit der Vorbereitung der elektrischen Analyse bzw. Auswahl der zu verbessernden Zelle eines IC befassen, seien nachfolgend die Möglichkeiten der Auswertung der elektrischen Analyse oder Optimierung noch näher betrachtet.

Eine Anwendungsmöglichkeit ist eine automatische Layoutmodifikation eines IC-Layouts als Basis zur Maskenherstellung einer Zelle eines IC bzw. des gesamten IC. Nach dem Umsetzen des bereits existierenden Layout- oder Schaltbildplans des herzustellenden IC wird das Fein-Grob-ComputermodeLL erzeugt oder alternativ aus einer Datenbank, in welcher für einzelne Zellen des herzustellenden IC bereits Fein-Grob-ComputermodeLL gespeichert sind, abgerufen. Anhand dieses Fein-Grob-ComputermodeLL wird dann eine Optimierung mit dem erfindungsgemäßen Iterationsverfahren durchgeführt. Das Optimierungsergebnis wird in ein an sich bekanntes Netzlistenprogramm eingespeist, mit dessen Hilfe eine Netzliste der optimierten Zelle hergestellt wird, die zur automatischen Generierung eines optimierten Layouts der Zelle bzw. des gesamten IC führt. Hierzu kann beispielsweise das Programm LAS der Firma Cadence oder ein entsprechendes Programm einer anderen Softwarefirma verwendet werden.

Eine andere Möglichkeit ist die, für dieselbe gewünschte Funktion verschiedene Lösungen zu vergleichen und unter bestimmten Gesichtspunkten, beispielsweise der Minimierung der Störabstrahlung, die bestmögliche Lösung programmgesteuert auswählen zu lassen. Zu diesem Zweck können verschiedene Zellen, die für die gleiche Aufgabe bestimmt sind, hinsichtlich des interessierenden Verhaltens, beispielsweise Störabstrahlverhaltens, analysiert und miteinander verglichen werden. Die Zelle mit dem besten Verhalten kann dann ausgewählt und für das herzustellende IC verwendet werden. Dieses Verfahren kann für nur eine Zelle des ICs durchgeführt werden oder auch für mehrere verschiedene Zellen des IC. Nach Beendigung dieses Zellauswahlverfahrens wird dann unter Berücksichtigung der ausgewählten Zelle bzw. Zellen ein Maskenlayout erstellt, was automatisch mit dem Gesamtprogramm geschehen kann. Das heißt, von der softwaremäßigen Erfassung der für die Auswahl zu vergleichenden Zellen bis zur Maskenherstellung kann ein durchgängig automatischer Verfahrensprozeß ablaufen, ohne daß irgendein menschlicher Eingriff erforderlich wäre.

Eine andere Anwendungsmöglichkeit der erfindungsgemäßen Methode ist die Ermittlung der optimalen Stützkapazität von auf dem IC mitintegrierten Stützkondensatoren und deren Trimmabgleich auf die als optimal ermittelte Stützkapazität.

Es ist üblich, integrierte Schaltungen mit integrierten Stützkapazitäten zu versehen, welche die Funktion eines

Strompuffers oder einer kleinen Pufferbatterie haben. Diese Stützkapazitäten wirken zwischen den beiden Spannungsversorgungsleitungen (VDD und VSS). Problematisch sind sie, da sie mit Induktivitäten, insbesondere von Leiterbahnen des IC, zu Serienresonanzen führen, entsprechend der bekannten Formel

$$f_r \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

Dabei bedeuten f_r die Serienresonanzfrequenz, L die Leiterbahneninduktivität und C die Stützkapazität. Bei der Resonanzfrequenz entsteht praktisch ein Kurzschluß zwischen den beiden Spannungsversorgungspolen. Dieser Effekt ist besonders unerwünscht, wenn er beispielsweise im Frequenzbereich von UKW- oder FM-Radiosendern, zum Beispiel im Bereich von 96 MHz, auftritt.

Ein derartiger Effekt kann auch bei integrierten Schaltungen auftreten, die nicht mit Stützkapazitäten versehen sind. Die Leiterbahnen von integrierten Schaltungen bilden bekanntlich Kapazitäten. Solche Leiterbahnenkapazitäten können zusammen mit Leiterbahneninduktivitäten ebenfalls zu Resonanzeffekten führen, die sich störend auswirken können.

Liegen solche Resonanzen in störenden Frequenzbereichen, kann man in bekannter Weise solche Resonanzen in unkritische Frequenzbereiche dadurch verlagern, daß man mittels Laserstrahlen oder Ionenstrahlen die betroffenen Leiterbahnen trimmt, also Teile solcher Leiterbahnen abträgt. Bei einem bereits existierenden IC ist ein solches Trimmen natürlich nur in einer Richtung möglich, weil die Leiterbahnen bzw. Elektroden von Stützkapazitäten durch solches Trimmen nur verkleinert werden können.

Unter Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens kann man ein solches Trimmen bereits anhand des Grob-Fein-Computermodells durchführen, was ein "virtuelles Trimmen" in beiden Richtungen erlaubt, nämlich in Richtung Verkleinerung als auch in Richtung Vergrößerung der zu trimmenden Leiterbahnen oder Kondensatorelektroden. Zu diesem Zweck kann mit dem erfindungsgemäßen Verfahren eine die betroffene Leiterbahn oder Kondensatorelektrode enthaltende Zelle des IC analysiert und in einem softwaremäßigen "Trimmvorgang" so optimiert werden, daß die genannten Frequenzen in einem unkritischen Frequenzbereich zu liegen kommen. Das Optimierungsergebnis kann dann in das Steuerprogramm zur Steuerung des Laser- oder Ionenstrahl-Trimngerätes eingegeben werden, um eine auf einem real existierenden IC bereits vorhandene Kondensatorelektrode oder Leiterbahn entsprechend dem Optimierungsergebnis zu trimmen.

Hierzu eignet sich beispielsweise ein Gerät mit der Bezeichnung Micrion 9000 der Firma Micrion in München. Dieses Gerät kann automatisch ICs ansteuern, und zwar programmierbar über seinen Steuerrechner. Über Schnittstellen oder Filter kann eine automatisierte Programmumsetzung vorgenommen werden, mittels welcher das mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erzielte Bewertungs- oder Optimierungsergebnis in das Steuerprogramm von Micrion 9000 eingespeist werden kann.

Wie bereits angesprochen, ist es besonders vorteilhaft, den Trimmvorgang softwaremäßig bereits durchzuführen, bevor überhaupt zu trimmende Leiterbahnen oder Kondensatorelektroden hergestellt werden. Ein solches Trimmen findet vorab softwaremäßig statt und es werden mit diesem Trimmergebnis bereits die Layout- und Leiterbahnenmasken gesteuert, vorzugsweise vollautomatisch, so daß die Erzeugung solcher Leiterbahnen und Kondensatorelektroden bereits mit dem optimierten Layout geschieht.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Analyse des elektrischen Verhaltens mindestens einer bestimmten Zelle einer monolithisch integrierten Schaltung, mit folgenden Schritten:

a) mittels eines bekannten Layout- oder Schaltbild-Analyseprogramms wird von der gesamten integrierten Schaltung anhand von deren Layout bzw. Schaltbild ein Fein-Grob-Computermodell erzeugt, indem erstellt werden:

a1) ein aktive und passive Bauelemente und parasitäre Komponenten berücksichtigendes Feinmodell von der interessierenden Zelle

a2) und ein nur passive Bauelemente in Form von komplexen Widerständen berücksichtigendes Grobmodell von mindestens dem Rest der integrierten Schaltung;

b) anhand des Fein-Grob-Computermodells wird eine Feinsimulation durchgeführt, indem vorbestimmte Betriebsparameter, wie insbesondere die Betriebstemperatur und die Versorgungsspannung, vorgegeben werden, mindestens ein Eingang des Feinmodells der Zelle mit mindestens einem Stimulationssignal beaufschlagt wird und dabei an Ausgangsanschlüssen der Zelle und/oder der integrierten Schaltung des Fein-Grob-Computermodells entstehende Signalverläufe abgetastet und aufgezeichnet werden;

- c) für jeden interessierenden Schaltungsknoten wird mittels einer Spektralanalyse-methode ein Frequenzspektrum des zugehörigen aufgezeichneten Signalverlaufs erstellt;
- d) das Frequenzspektrum wird durch Vergleich mittels einer gespeicherten Frequenzspektrumbewertungs-schablone bewertet.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem vor Schritt a) folgende zusätzliche Schritte durchgeführt werden:

- e) mittels des bekannten Layout- oder Schaltbild-Analyseprogramms wird von der gesamten integrierten Schaltung anhand von deren Layout bzw. Schaltbild ein nur deren aktive Bauelemente berücksichtigendes Grobsimulationscomputermodell erzeugt;
- f) es wird eine Grobsimulation durchgeführt, indem die vorbestimmten Betriebsparameter vorgegeben und Eingangsanschlüsse des Grobsimulationscomputermodells mit Testsignalen vorbestimmter Signalform beaufschlagt und dabei an Ein-und/oder Ausgangsanschlüssen der interessierenden Zelle des Grobsimulations-computermodells entstehende analoge Antwortsignale als Stimulationssignale aufgezeichnet und gespeichert werden;
- und bei welchem bei der Feinsimulation gemäß Schritt b) die in Schritt f) aufgezeichneten Stimulationssignale verwendet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, zur Verbesserung des elektromagnetischen Emissionsverhaltens der Zelle der integrierten Schaltung, wobei mittels einer programmgesteuerten Iterationsroutine und unter Beachtung vorbe-stimmter Funktionsgrenzen der Zelle

- g) Schaltungsparameter des Feinmodells der Zelle gezielt geändert werden;
- h) anhand des sich daraus ergebenden geänderten Fein-Grob-Computermodells die Schritte b) bis d) wieder-holt werden;
- i) das mit dem geänderten Fein-Grob-Computermodell jeweils erhaltene Bewertungsergebnis mit dem Bewer-tungsergebnis verglichen wird, das mit dem vorausgehenden Fein-Grob-Computermodell erhalten worden war;
- j) anhand des Vergleichsergebnisses ermittelt wird, ob die vorausgehende Änderung von Schaltungsparame-tern des Feinmodells zu einer Verbesserung oder Verschlechterung des elektromagnetischen Emissionsver-haltens der Zelle geführt hat;
- k) die Iterationsroutine mit erneuter Änderung der Schaltungsparameter des Feinmodells der Zelle fortgeführt wird, wobei die Schaltungsparameteränderung in Abhängigkeit von dem vorausgehenden Ermittlungsergebnis in gleicher oder entgegengesetzter Richtung wie bei der vorausgehenden Schaltungsparameteränderung vor-genommen wird, bis der Betrag der durch die jeweilige Schaltungsparameteränderung erzielten Änderung des elektromagnetischen Emissionsverhaltens unter einem vorbestimmten Schwellenwert zu liegen kommt.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei welchem für die Erstellung des Grobmodells neben dem Modell des Restes der integrierten Schaltung berück-sichtigt werden:

- ein Zuleitungsmodell und/oder
- ein Spannungsversorgungsmodell und/oder
- ein Eingangs/Ausgangsstrukturmodell und/oder
- ein Gehäusestrukturmodell und/oder
- ein Lastmodell.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei welchem bei den Schritten a) und e) mittels eines Schaltungslayoutprogramms eine Netzlistenbeschreibung des Fein-Grob-Computermodells bzw. des Grobsimulationscomputermodells erstellt wird, welche passive und parasitäre Elemente in Form von Widerständen (R), Kapazitäten (C) und Induktivitäten (L) und aktive Elemente in Form von Transistoren und Dioden berücksichtigt.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei welchem die Grobsimulation gemäß Schritt e) mit Testsignalen durchgeführt wird, die zu einer möglichst peri-odischen Arbeitsweise des Grobsimulationscomputermodells führen.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,

bei welchem bei den Schritten b) und f) Betriebsparameter für typischen Betrieb vorgegeben werden.

- 5 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
bei welchem bei den Schritten b) und f) Betriebsparameter für schlechteste Betriebsbedingungen vorgegeben werden.
- 10 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
bei welchem im Rahmen von Schritt b) ein an mindestens einem Ausgangsschaltungsknoten der integrierten Schaltung entstehender Signalverlauf aufgezeichnet wird.
- 15 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
bei welchem die Abtastung im Rahmen von Schritt b) mit einer Abtastfrequenz durchgeführt wird, die mindestens so hoch ist wie die vom Abtasttheorem geforderte Abtastfrequenz.
- 20 11. Verfahren nach Anspruch 10,
bei welchem die Abtastung mit einer Abtastfrequenz durchgeführt wird, die mindestens fünf mal so hoch ist wie die vom Abtasttheorem geforderte Abtastfrequenz.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
bei welchem bei Schritt c) die zu analysierenden Signalverläufe einer Fouriertransformation unterzogen werden.
- 25 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
bei welchem bei Schritt c) die zu analysierenden Signalverläufe einer Z-Transformation unterzogen werden.
- 30 14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
bei welchem im Rahmen der Feinmodellerstellung bei Schritt a) zunächst mittels eines herkömmlichen programm-
gesteuerten Extraktionsverfahrens die zwischen je zwei Schaltungsknoten vorhandenen parasitären Elemente je
in Form einer komplexen Impedanz extrahiert und diese danach mittels eines Computerprogramms in ein Ersatz-
netzwerk mit verteilten Impedanzelementen umgewandelt wird.

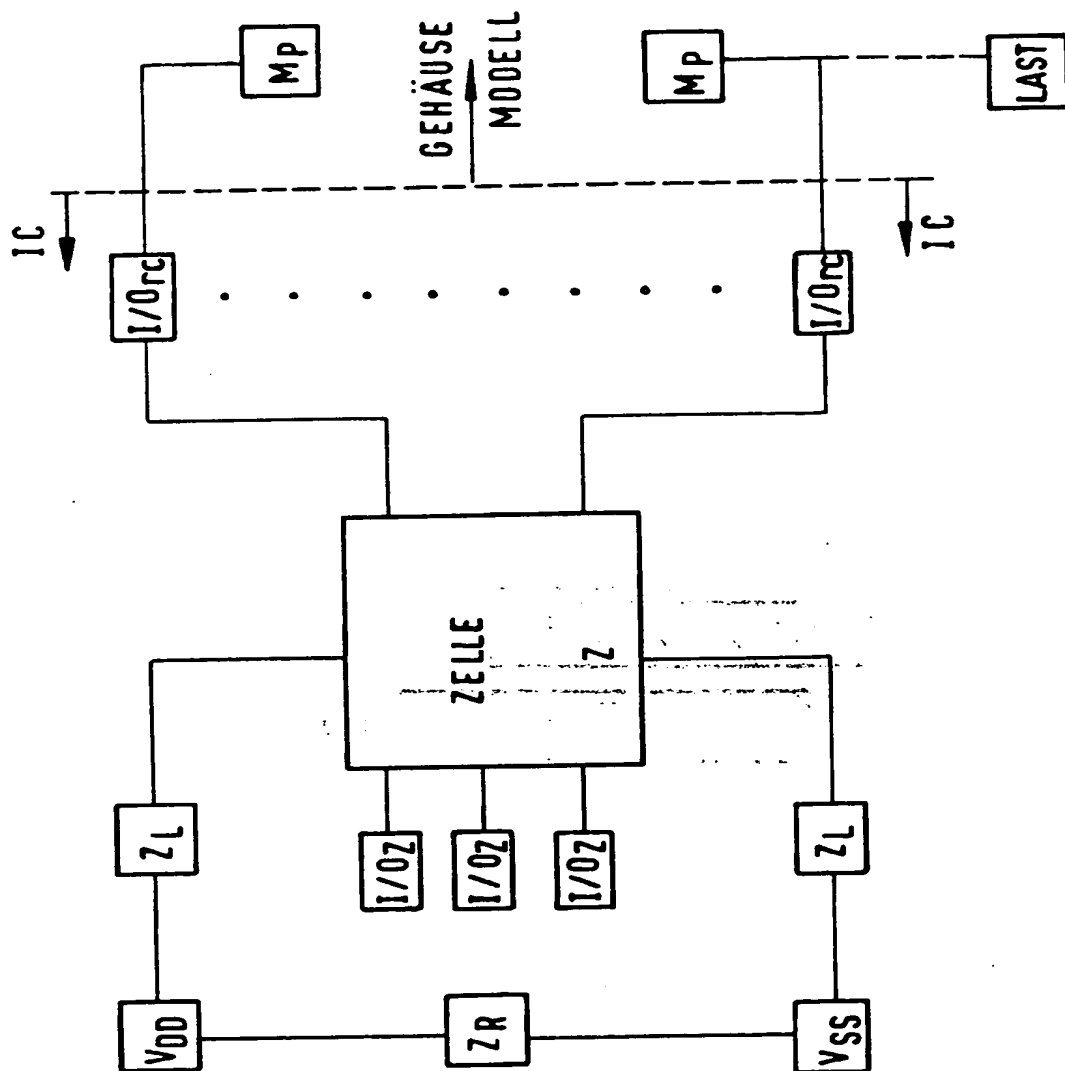
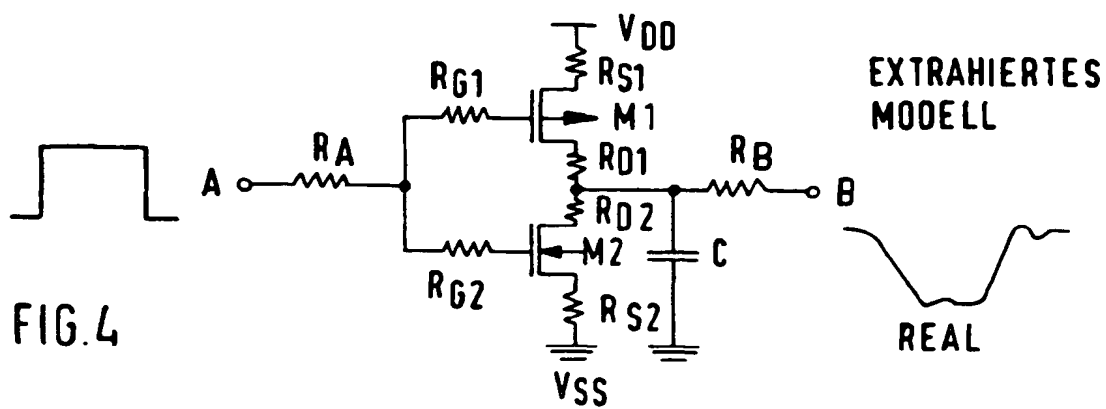
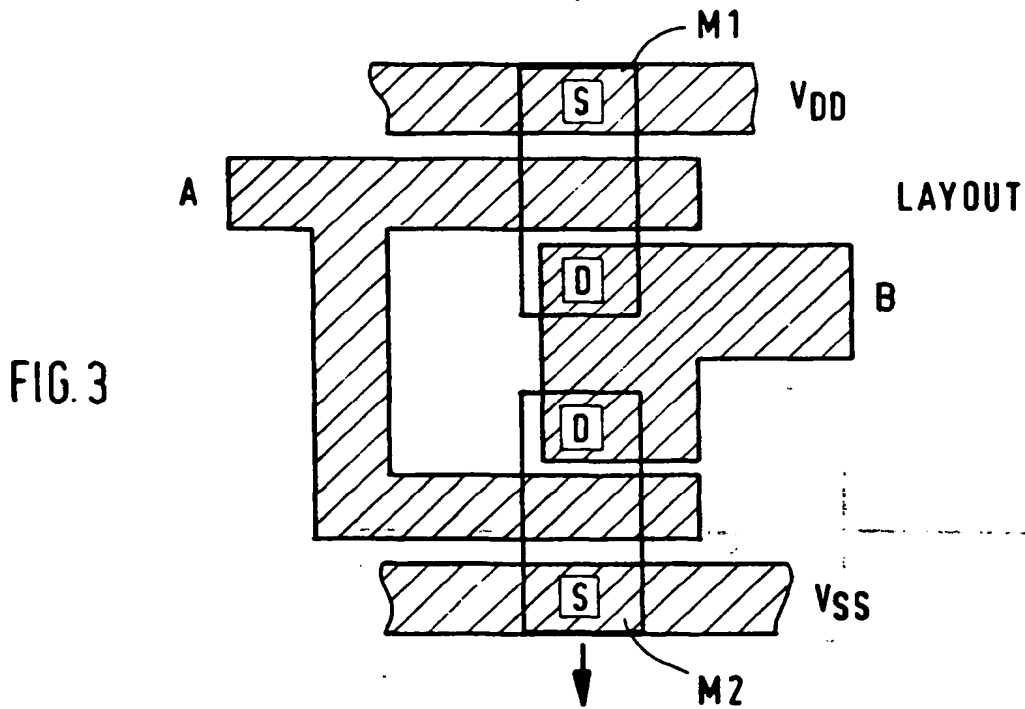
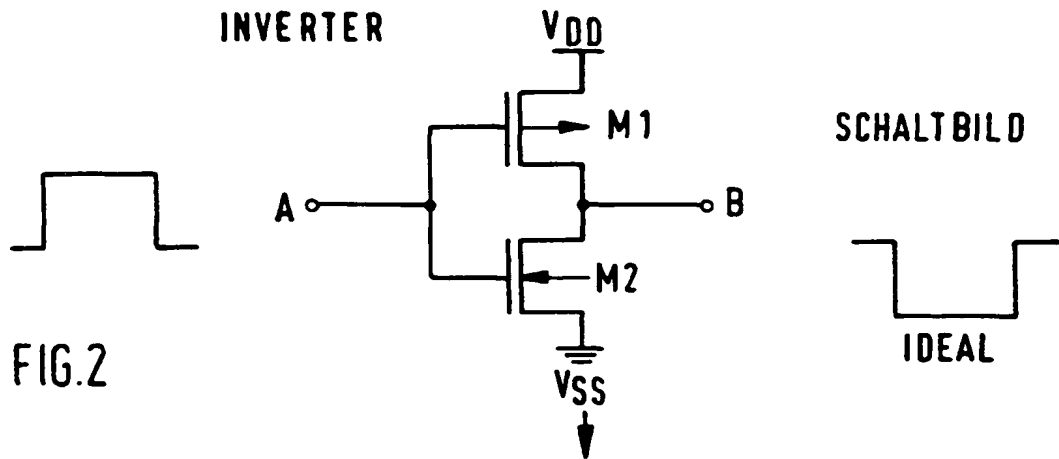


FIG.1



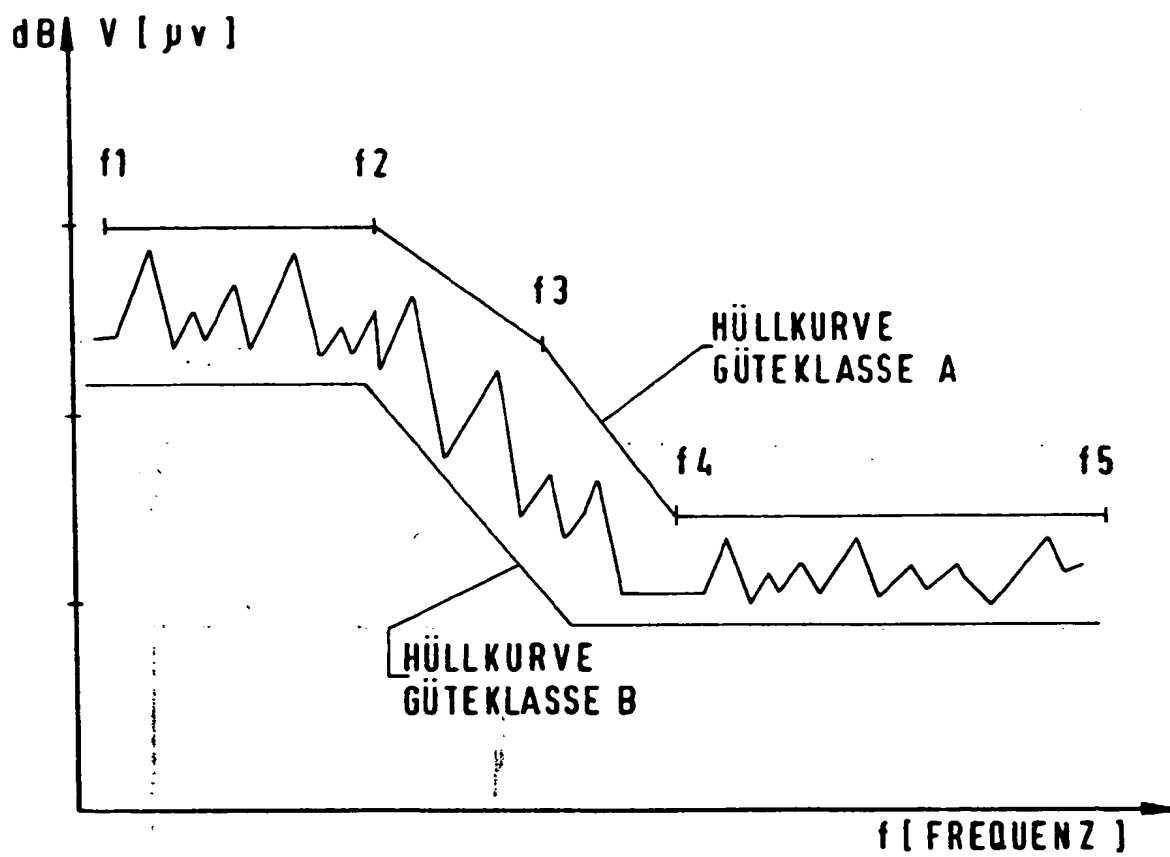
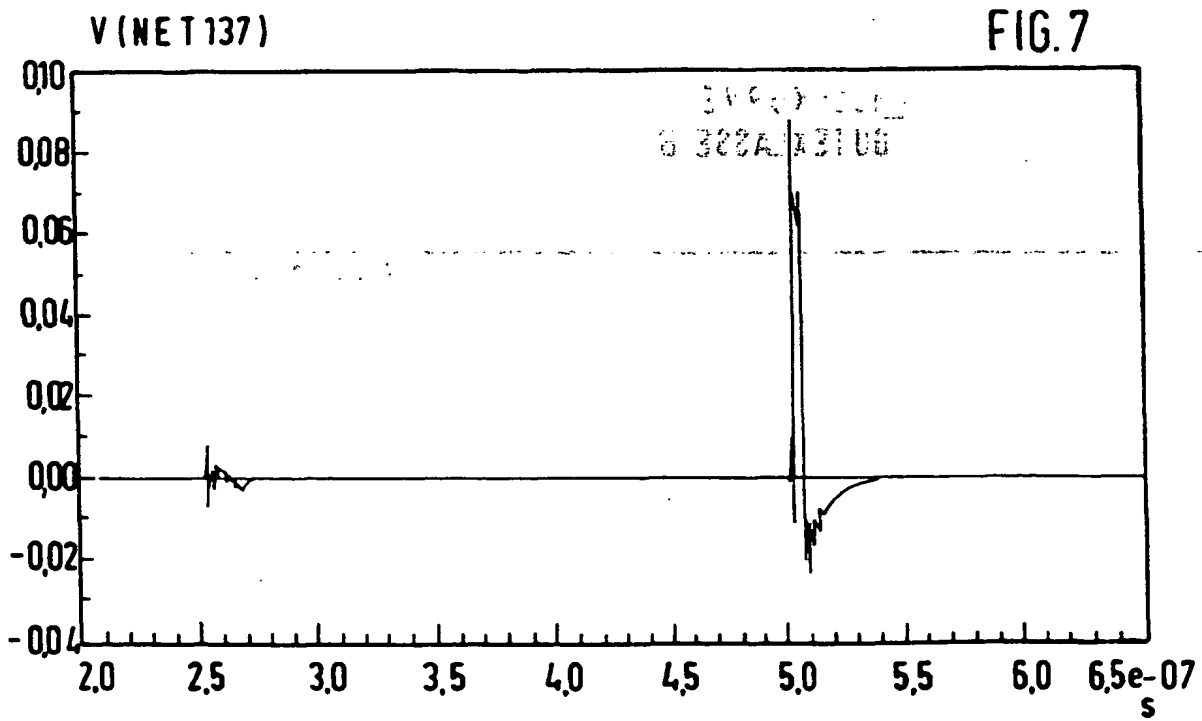
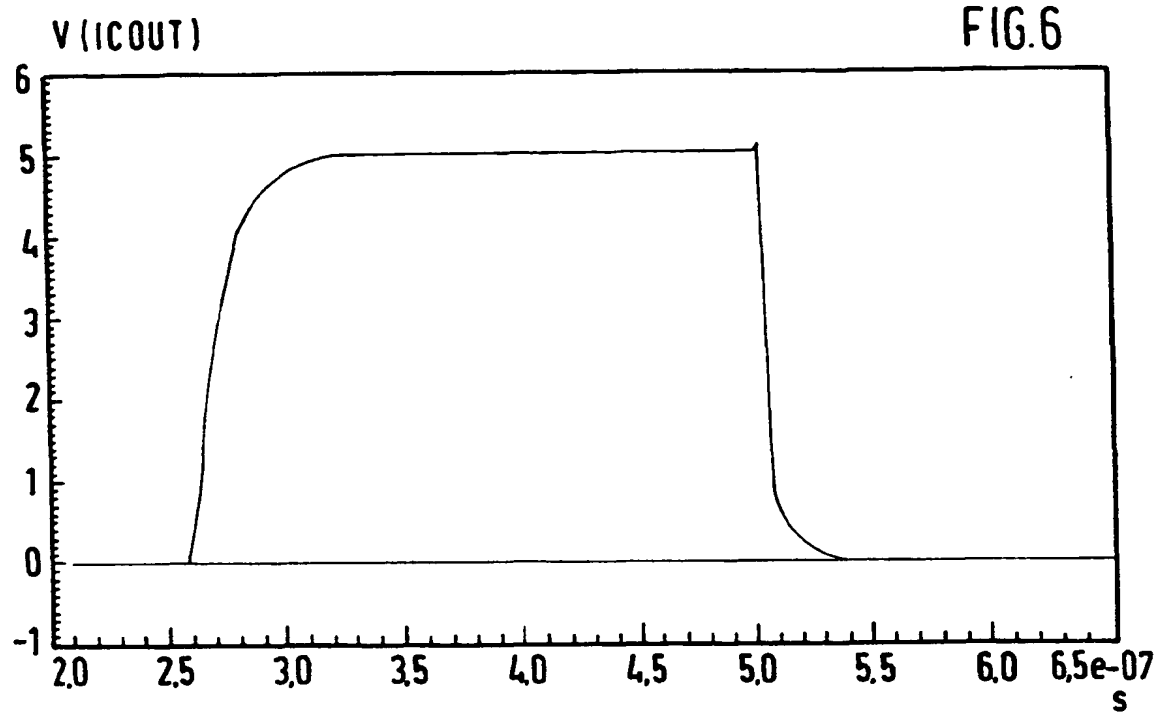


FIG. 5



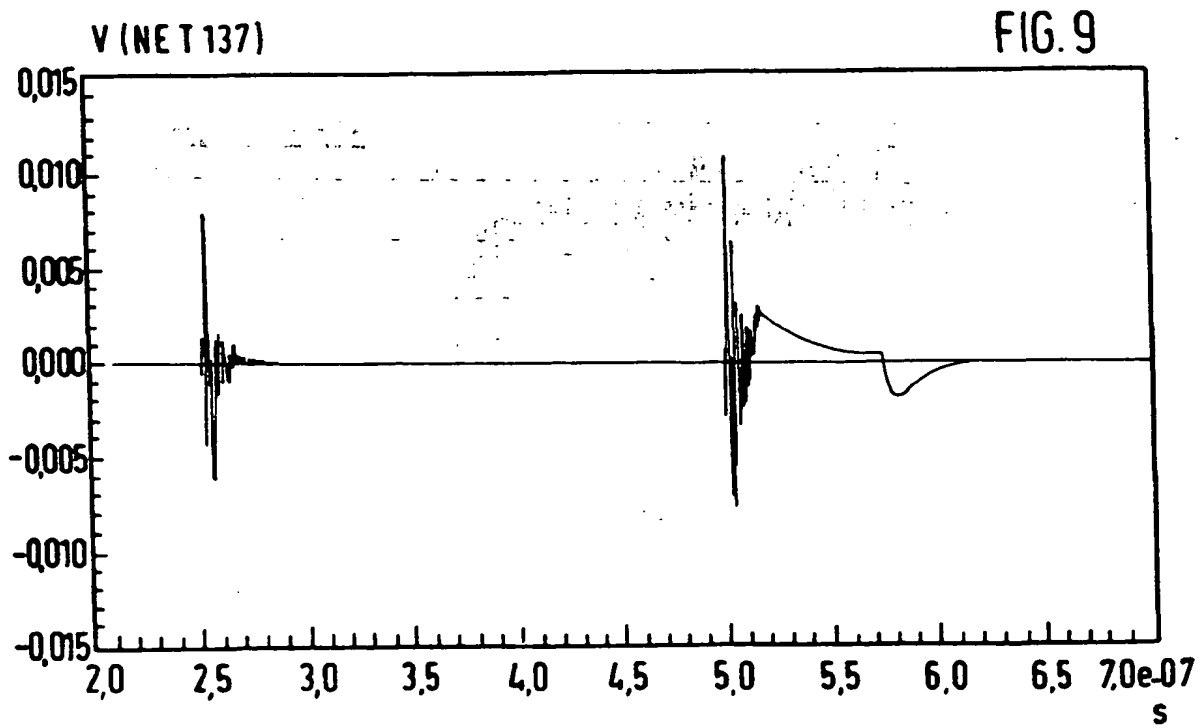
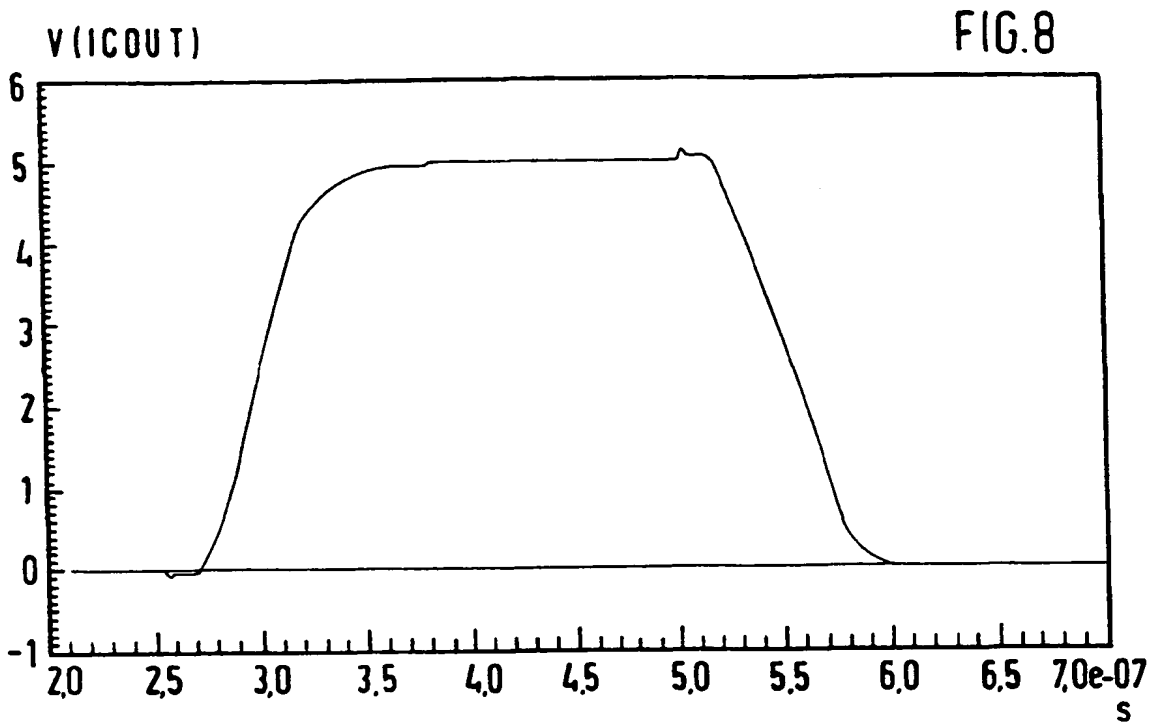


FIG.11

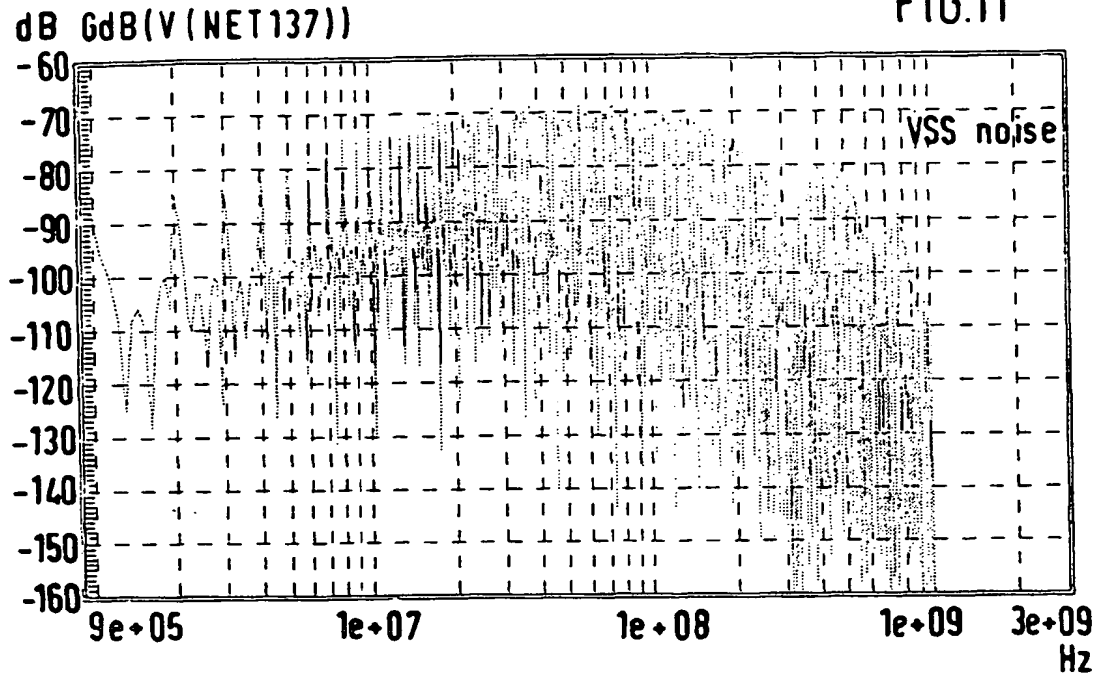
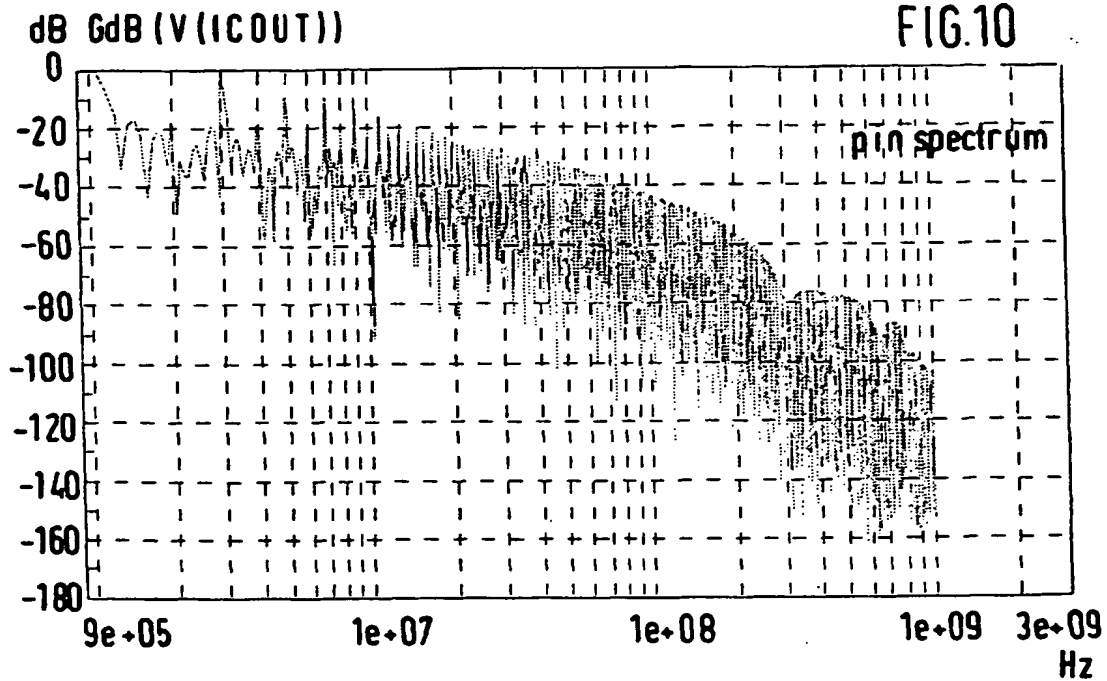
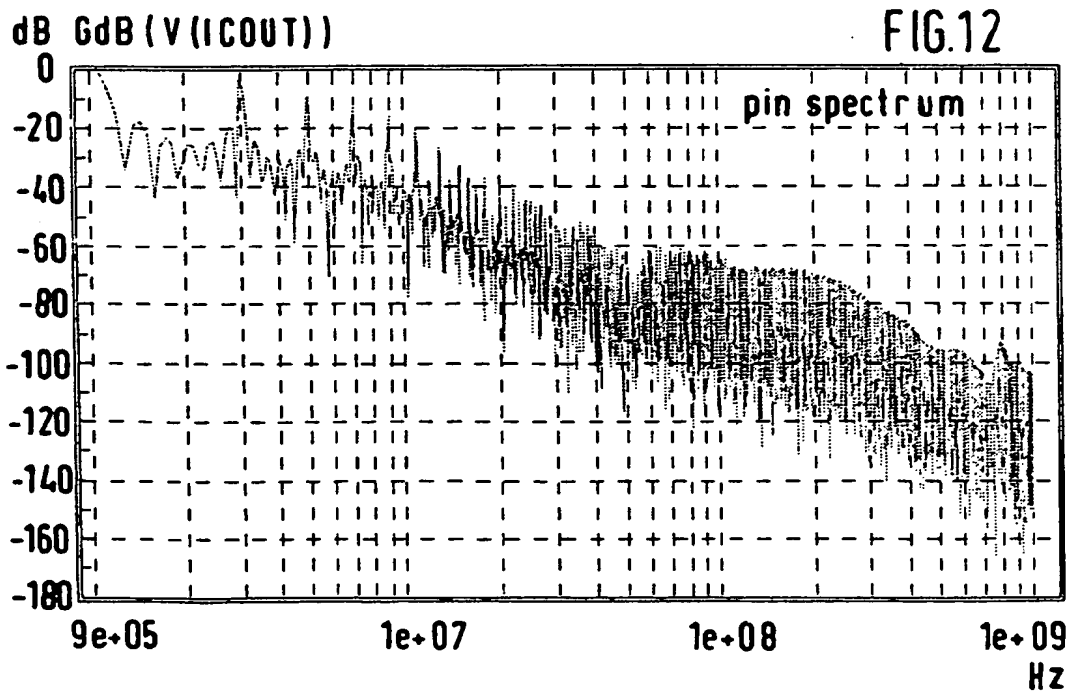
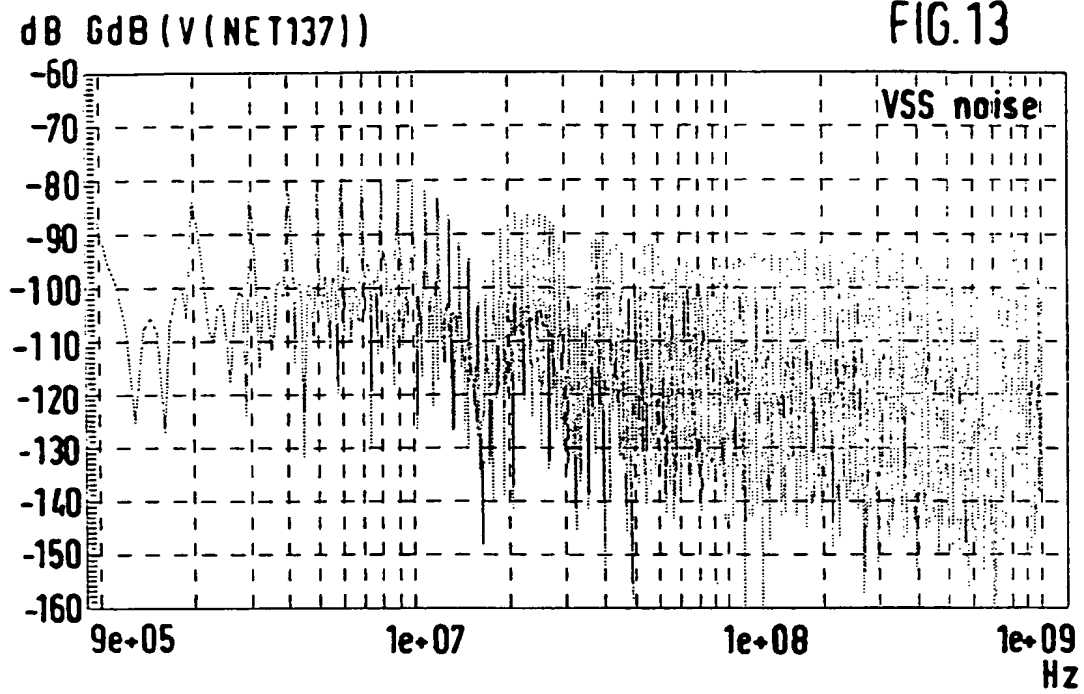


FIG.10







Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 98 10 1077

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
A	EP 0 481 117 A (SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT) * das ganze Dokument *	1-14	G06F17/50
A	P. BECQUE: "Getrennt spezifizieren, vereint simulieren" ELEKTRONIK, Bd. 44, Nr. 20, 6. Oktober 1995, POING, DE, Seiten 102-108, XP000535709 * das ganze Dokument *	1-14	
A	EP 0 556 900 A (PHILIPS ELECTRONICS UK LIMITED) * das ganze Dokument *	1-14	
A	T. J. THATCHER ET AL: "Automatic Partitioning and Dynamic Mixed-Mode Simulation" IEEE 1992 CUSTOM INTEGRATED CIRCUITS CONFERENCE, 3. - 6. Mai 1992, BOSTON, MA, US. Seiten 12.7.1-12.7.4, XP000340900 * das ganze Dokument *	1-14	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			G06F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 23. März 1998	Prüfer Abram, R
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie		& : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03/82 (P04C03)

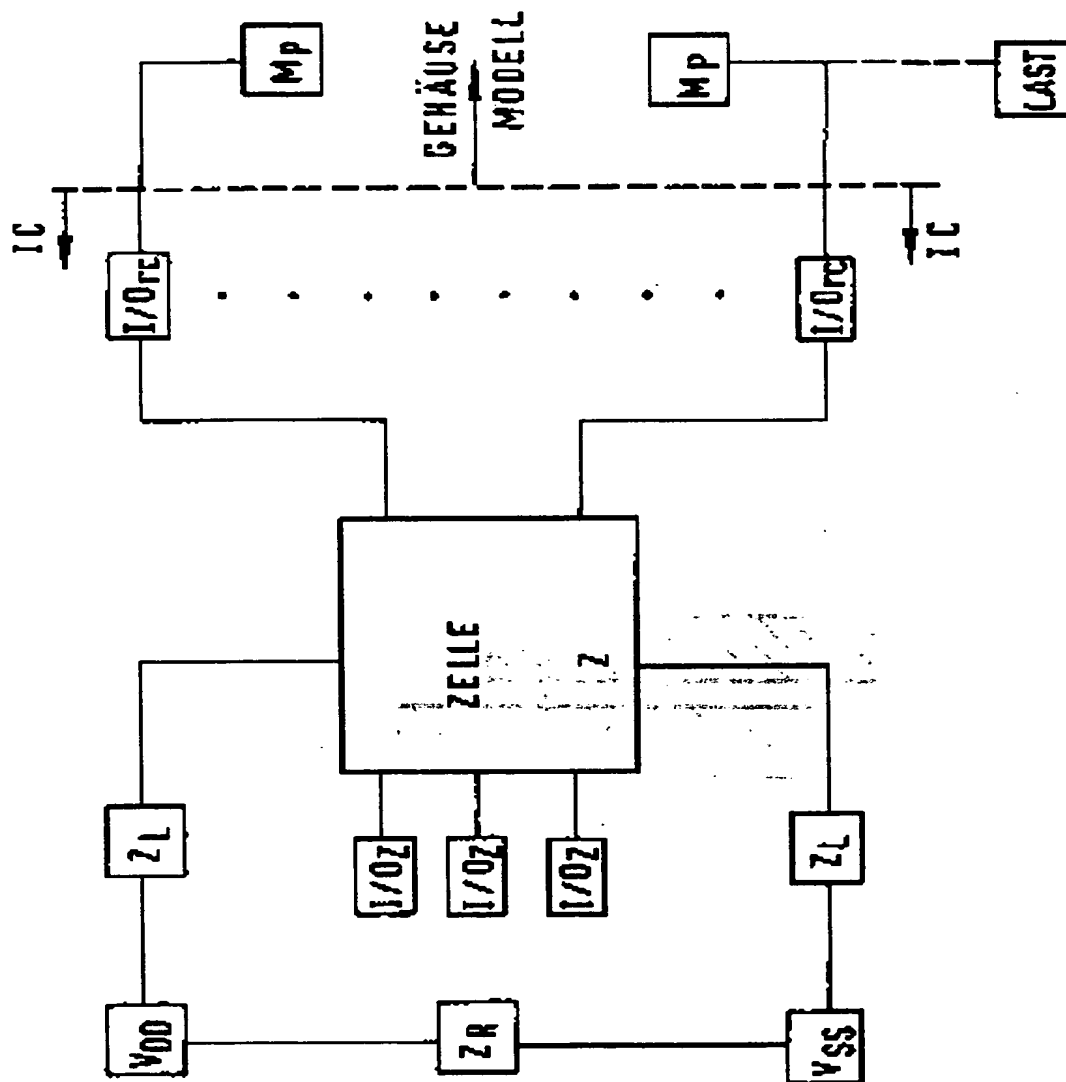
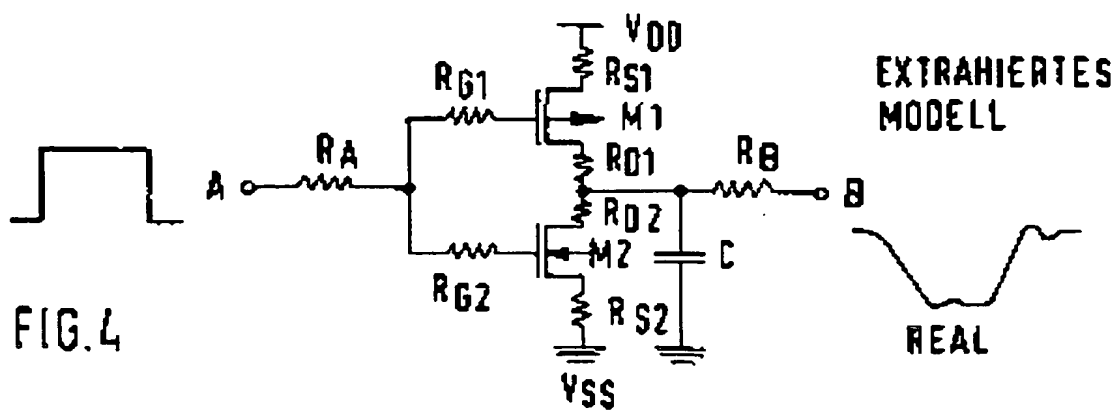
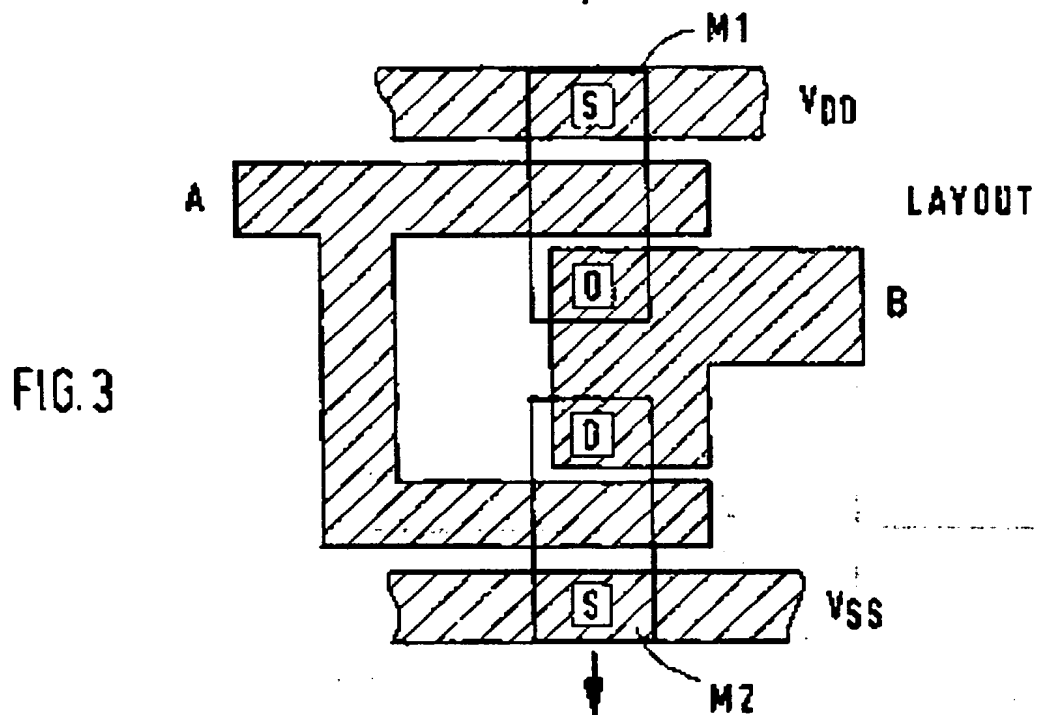
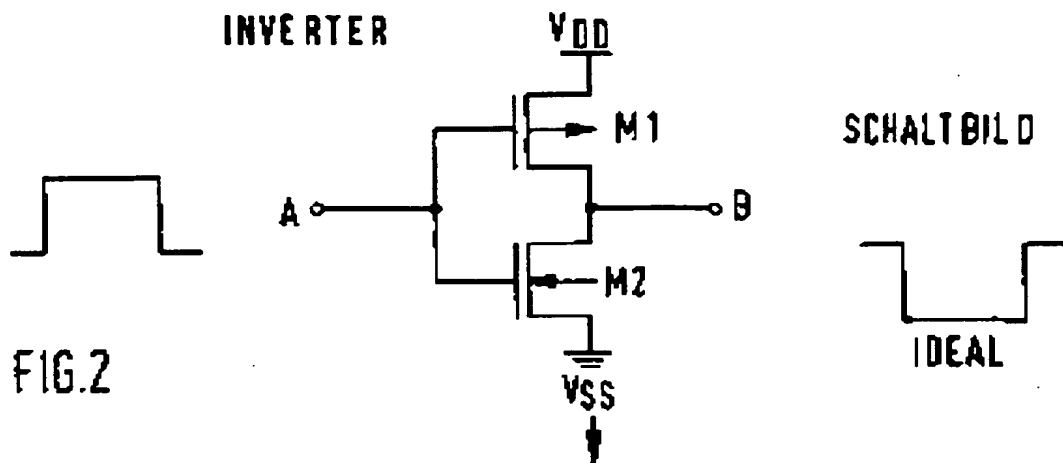


FIG. 1



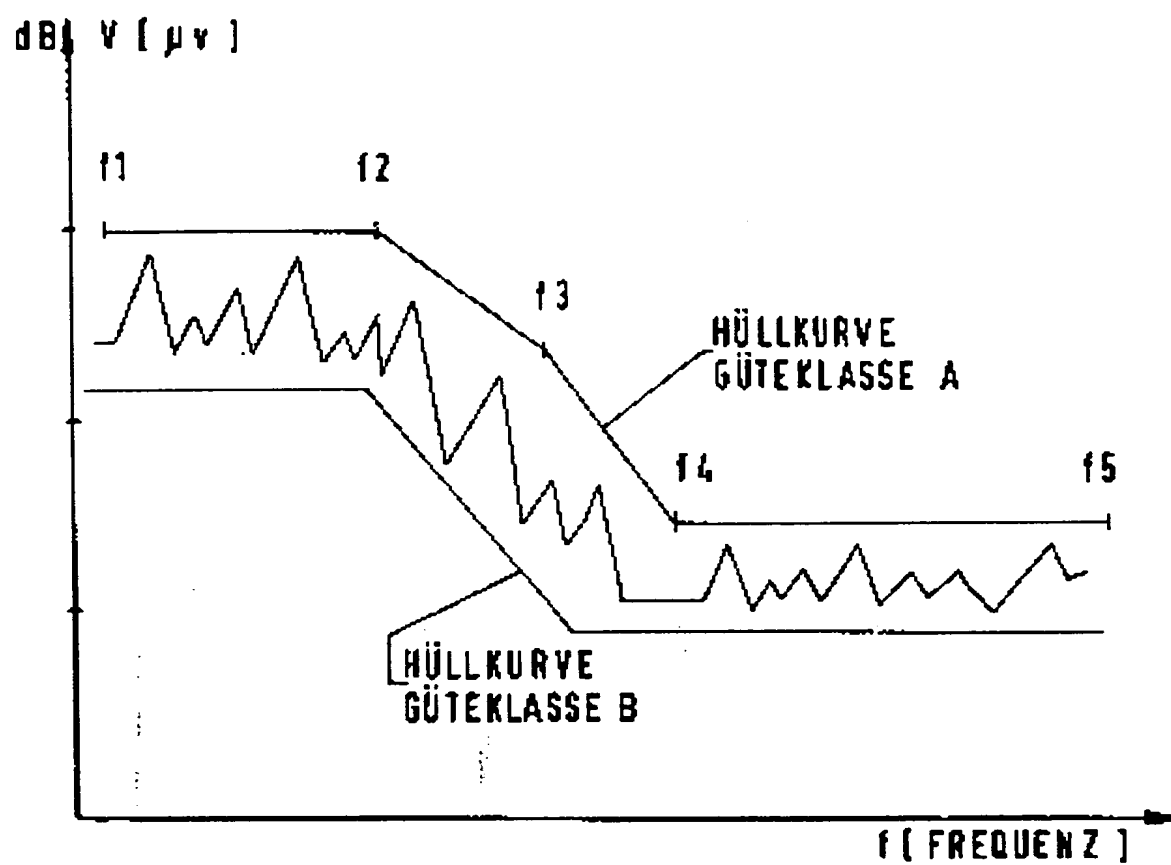
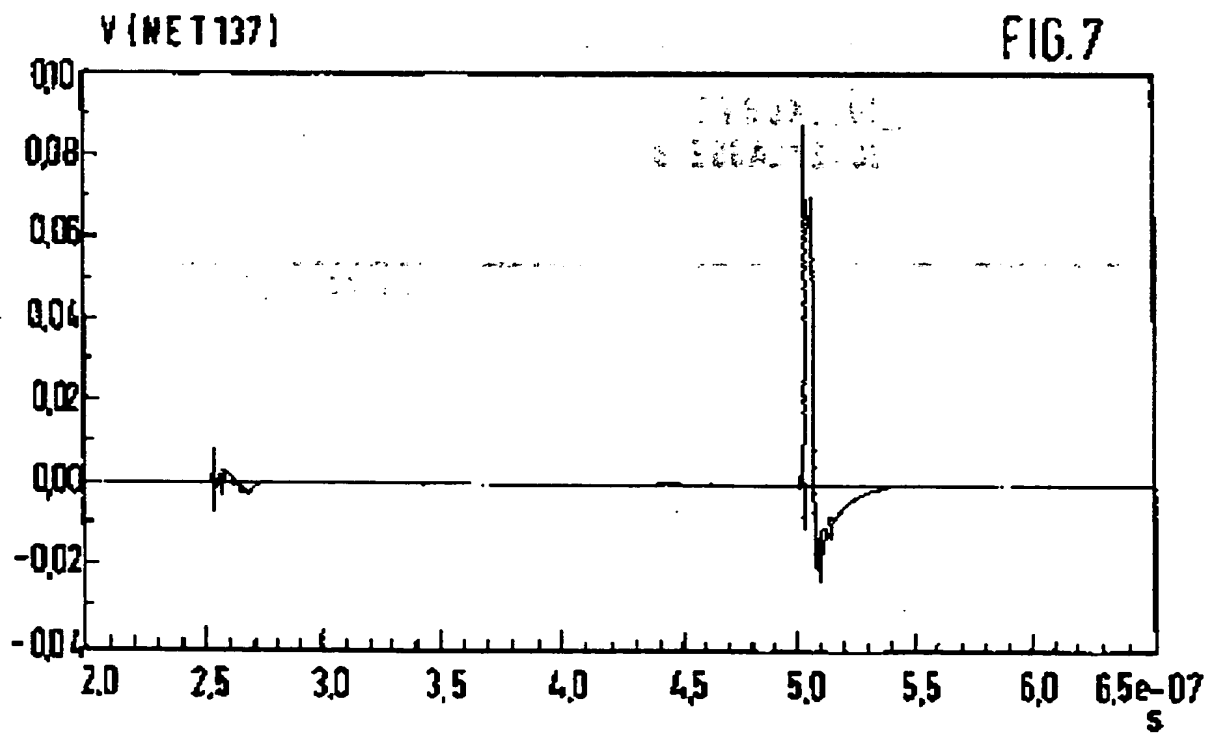
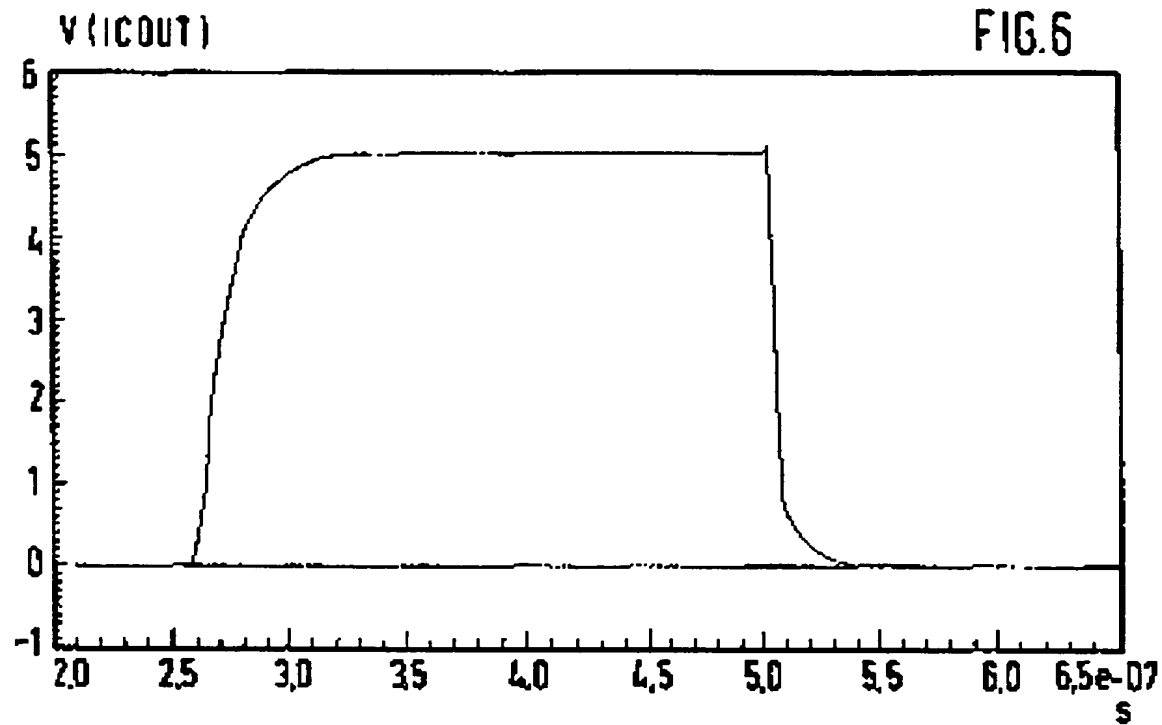
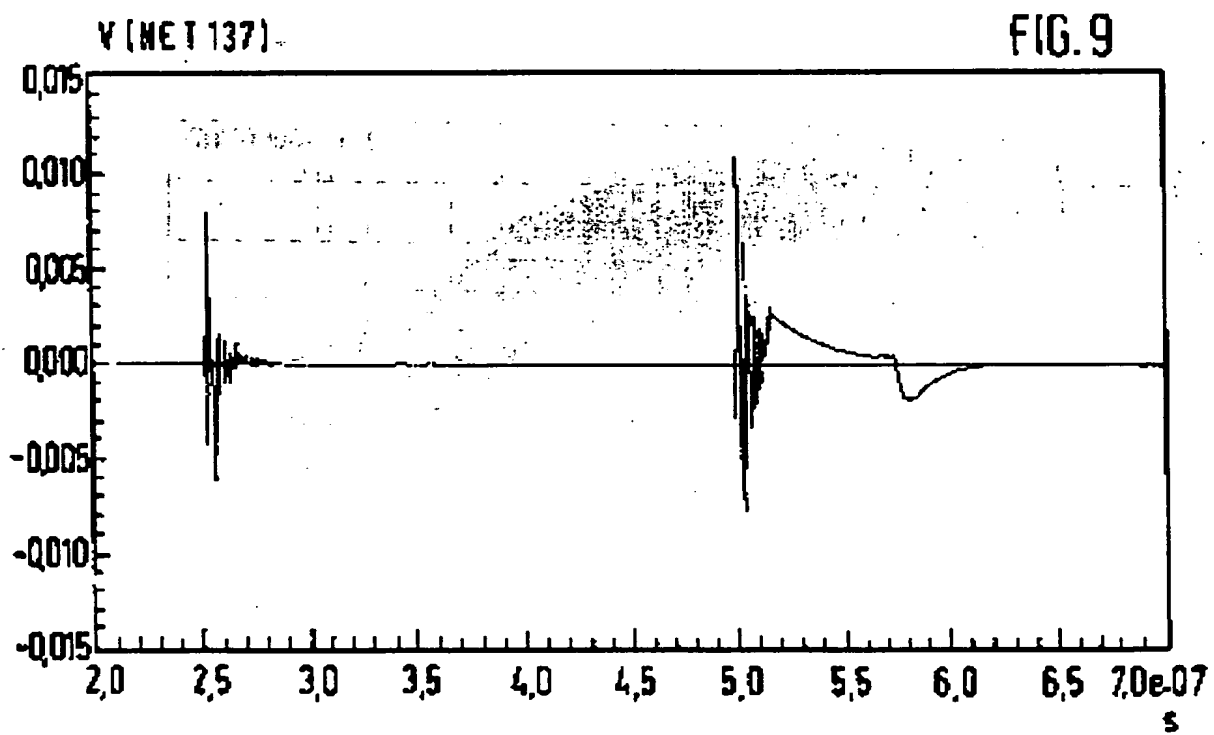
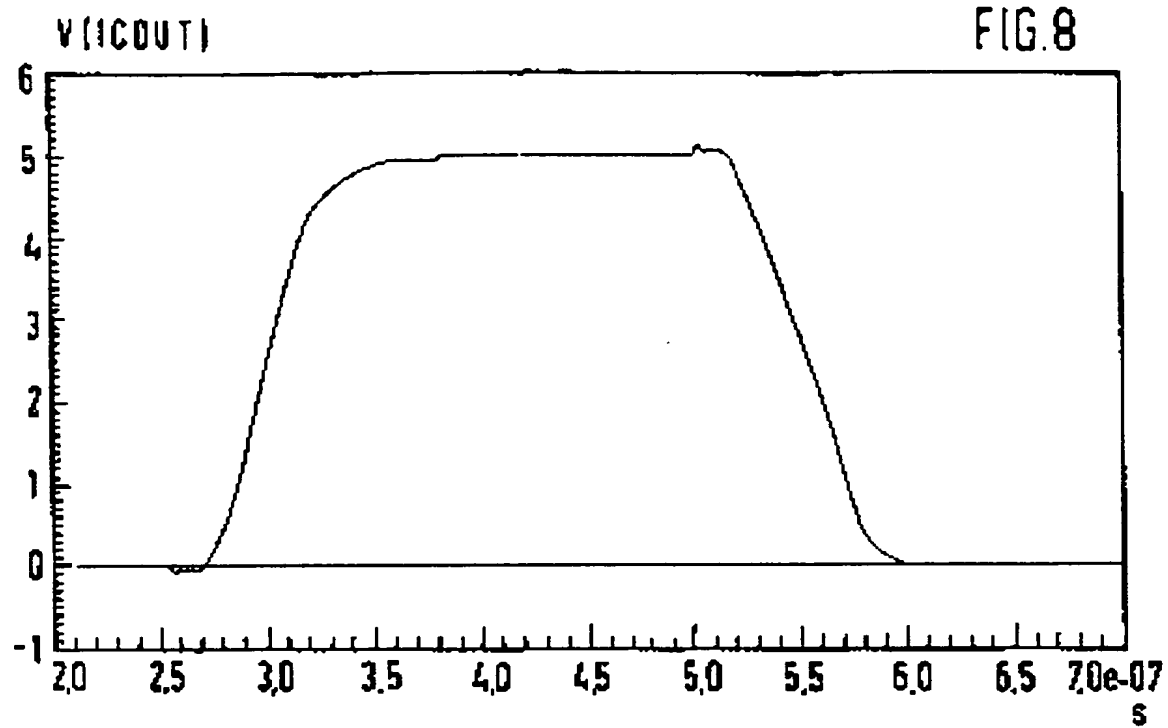
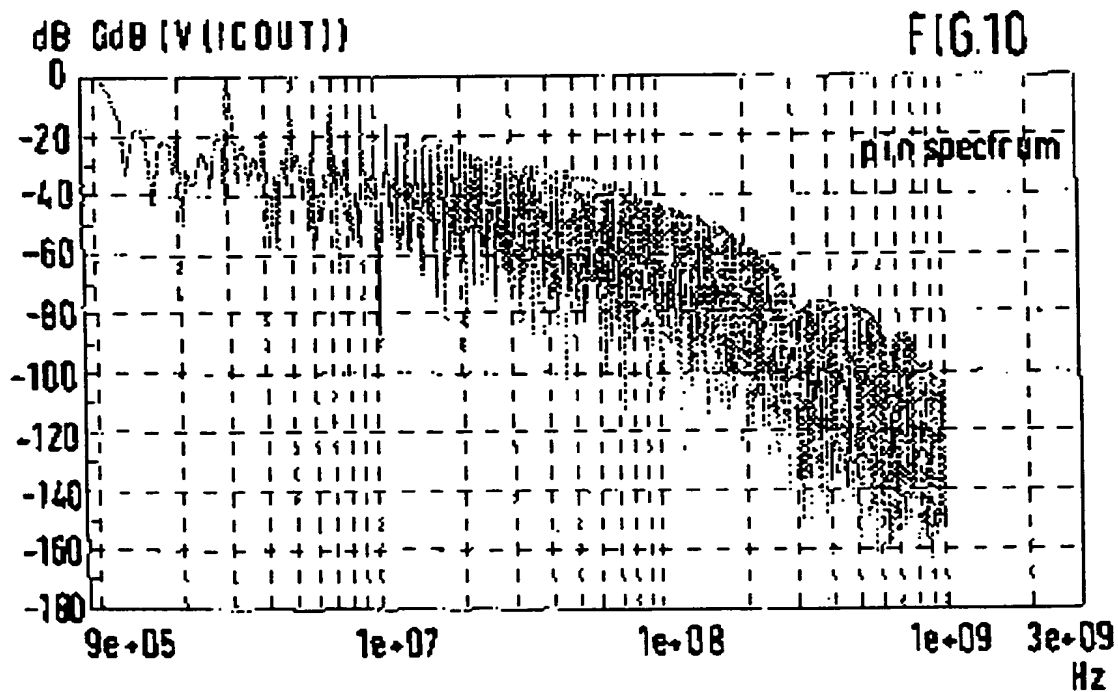
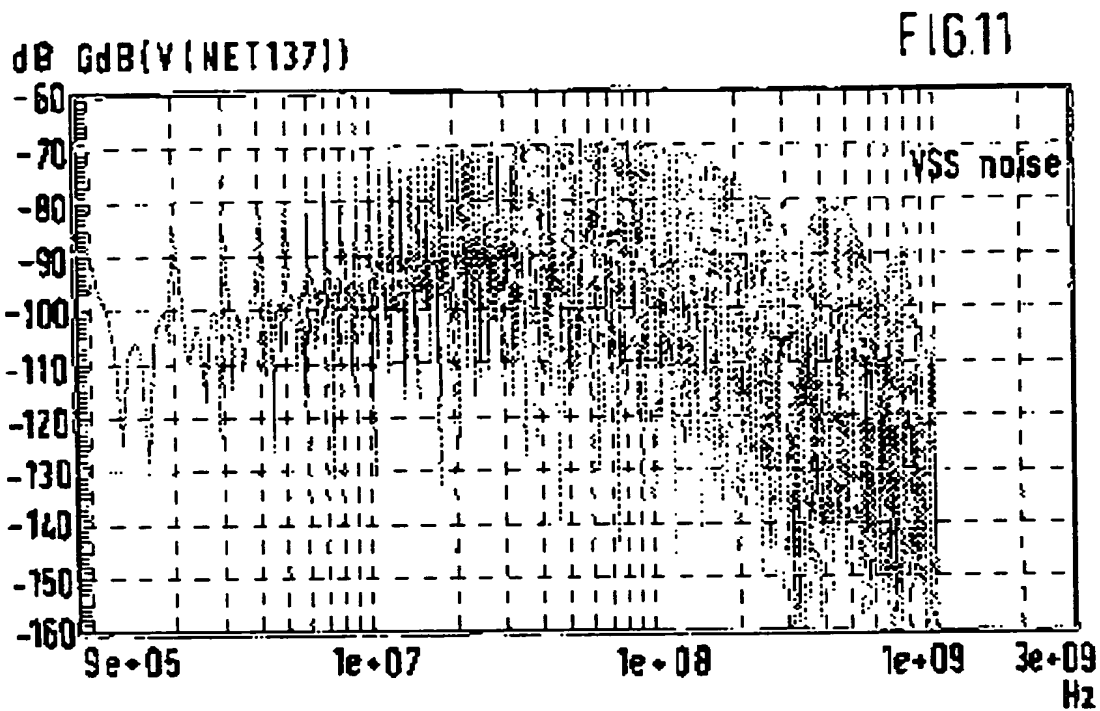


FIG. 5

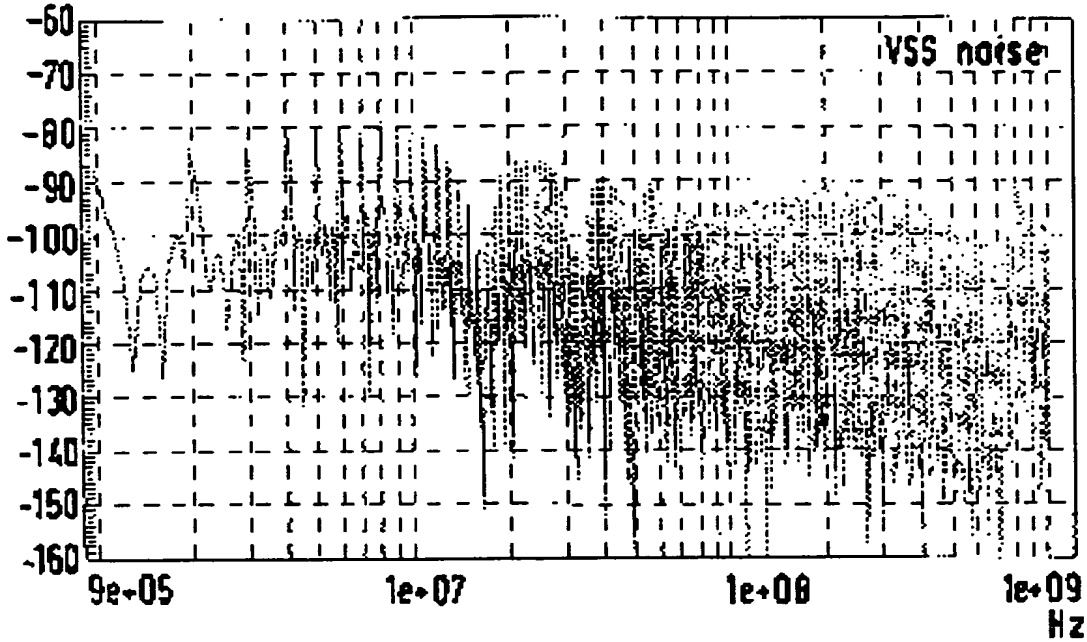






dB GdB(V(NE1137))

FIG.13



dB GdB(V(ICOUT))

FIG.12

